

**Всесоюзный  
Центр  
Переводов**

**АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ**



Государственный комитет СССР  
по науке и технике

Академия наук  
СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИИ

В помощь переводчику

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ

С о с т а в и т е л ь  
Н.А. Соболева

П о д р е д а к ц и е й  
А.Д. Хаятина

Москва 1990

УДК 802.0=801,18:681.3

Ответственный редактор  
И.И. УБИН

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Выпуск содержит свыше 1000 сокращений многословных терминов по электронной технике, используемых в англоязычной научной и технической периодике, каталогах, проспектах зарубежных фирм, и охватывает следующие разделы: электронные приборы и их элементы, оптоэлектронные приборы, материалы электронной техники, технология электронных приборов, а также используемые в электронной технике физические понятия, методы исследования физических характеристик электронных приборов и материалов.

Замечания и предложения по содержанию выпуска просим направлять по адресу:  
117218, Москва, В-218, ул. Кржижановского,  
д. 14. корп. 1, Всесоюзный центр переводов.

## А

AARM /advanced atom resolution microscope/	AC PDP /alternate current plasma display panel/
усовершенствованный /электронный/ микроскоп с атомарным разрешением	газоразрядная индикаторная панель /ГИП/ переменного тока
AAS /atomic absorption spectrometry/	ACSFET /acoustically sensitive FET/
спектрометрия атомного поглощения	акусточувствительный ПТ
ABSS /acoustic back-scattering system/	ACR /advanced carbon-thermic reduction/
установка обратного рассеяния акустических волн	улучшенный карботермический метод восстановления SiO <sub>2</sub> /получение Si солнечного качества/
ACAS /automatic component assembly system/	ACTV /advanced compatible TV/
автоматизированная система монтажа электронных компонентов	телевидение с улучшенной совместимостью
ACCESS /automatic computer-controlled electronic scanning system/	ADB-II/III, IV/
автоматизированная система электронного сканирования с управлением от ЭВМ	/advanced bipolar/
ACD /air-cooled device/	улучшенная биполярная технология с 2/3, 4/ уровнями металлизации
прибор с воздушным охлаждением	ADFET /adsorption FET/
ACL /advanced CMOS logic/	ПТ /с открытым затвором/, чувствительный к адсорбции газов
усовершенствованная логическая КМОП ИС	см. также OGFET
	AES /atomic emission spectroscopy/
	атомная эмиссионная спектроскопия
	AF /acceleration factor/
	коэффициент ускорения

AG /as-grown/  
только-что выращенный  
/свежевыращенный/  
AGE /above (band) gap  
excitation/  
возбуждение с переходом  
электрона через запре-  
щенную зону  
ALD /atomic layer  
doping/  
легирование путем нане-  
сения атомарного слоя  
/примеси/  
ALICISS /alkali im-  
pact-collision ion-  
scattering spectro-  
scopy/  
ионно-рассеивательная  
спектроскопия в режиме  
ударных столкновений с  
использованием первичных  
ионов щелочных металлов  
ALPEN /alpha-particle-  
induced penetration/  
эффект проникновения,  
индуцированный бомбарди-  
ровкой альфа-частицами  
AMPL-EB /amplitude-  
modulated pseudo-  
line electron beam/  
псевдолинейный электрон-  
ный луч с амплитудной  
модуляцией  
ANOX /anodic oxida-  
tion/  
анодное окисление, ано-  
дирование  
APCVD /atmospheric  
pressure chemical  
vapour deposition/

химическое осаждение из  
паровой фазы при атмос-  
ферном давлении

AREM /atom-resolu-  
tion electron micro-  
scope/  
электронный микроскоп  
с атомарным разрешением

ARFET /all-refracto-  
ry-metal/MES FET/  
ПТ с затвором Шоттки на  
основе тугоплавкого ме-  
талла /напр., GaAs/Ta/

ARPS /angle-resolved  
photoemission spect-  
roscopy/  
фотоэмиссионная спектро-  
скопия с угловым разре-  
шением

ARROW /antiresonant  
reflecting optical  
waveguide/  
противорезонансный отра-  
жающий оптический волно-  
вод

AS /absorption  
spectroscopy/  
спектроскопия оптиче-  
ского поглощения, абсорб-  
ционная спектроскопия

ASA /atomic-sphere  
approximation/  
приближение атомных обо-  
лочек

ASE /automatic spect-  
roscopic ellipso-  
metry/  
автоматизированная спе-  
ктроэллипсометрия

ASGC /automatic slope  
and gain control/  
автоматическое регули-  
рование крутизны и уси-  
ления

ASLSI /application  
specific LCI/  
специализированная /за-  
казная/ БИС

ASTM /automated scan-  
ning tunnelling mic-  
roscopy/  
автоматизированная скани-  
рующая туннельная микро-  
скопия

ASTM /automatic scan-  
ning test method/  
метод испытаний с авто-  
матическим сканированием

ATCB /automated tape  
carrier bonding/  
автоматический монтаж  
ИС на ленточный носи-  
тель

ATO PR /ambient-tem-  
perature-operation  
photoresistor/  
неохлаждаемый фоторезис-  
тор

AVIRIS /airbord vi-  
sible/IR imaging  
spectrometer/  
бортовая система спект-  
роскопии видимых/ИК изо-  
бражений

AVLSI //advanced  
VLSI/  
усовершенствованная  
СБИС

AX /acceptor-like  
center/  
акцептороподобный центр

AXIOM /axial injec-  
tion orbitron maser/  
орбитрон с осевой инжек-  
цией

AW-SEED /asymmetric  
well self-electrooptic  
device/  
прибор с собственным  
электрооптическим эффек-  
том с асимметричной  
квантовой ямой

## В

BACK-MIS /back col-  
lection type MIS so-  
lar cell/  
новый тип тонкопленочно-  
го МДП Si солнечного  
элемента с тыловым кол-  
лектором

BAT /binary-adressing  
technique/  
техника двойной адреса-  
ции

BBD /bulk-barrier  
diode/  
диод с внутренним унипо-  
лярным барьером /ВУБ-  
диод/ /n<sup>+</sup> p n/

BB-PD /bell-bottom  
photodiode/  
элемент фотодиодной мат-  
рицы с колоколообразной  
n-областью с широким  
дном

BBR /band-bending re-  
gion/  
область изгиба зон

BC /buried channel/  
скрытый /заряженный/  
канал

BC /buried crescent/  
скрытая серповидная об-  
ласть

BC-CPD /buried-chan-  
nel charge priming  
device/  
прибор с подкачкой заря-  
да со скрытым каналом

BCD /buried-channel  
double-diffused drain  
FET/  
ПТ со скрытым каналом и  
образованным двойной диф-  
фузией стоком

BCDMOS /bipolar CMOS-  
double-diffused MOS/  
комбинация биполярной  
КМОП и МОП-структуры,  
изготовленной по техно-  
логии двойной диффузии

BCRW /bridge-contacted  
ridge-waveguide laser/  
лазерный диод с контакт-  
ным мостиком и реберным  
волноводом

BCS /Bardin-Couper-  
Schriffer/  
теория Бардина-Купера-  
Шриффера /БКШ/

BE /birefringence  
effect/  
эффект двулучепреломле-  
ния

BE /bound exciton/  
связанный экситон

BEO /band-edge off-  
set/

смещение краев энерге-  
тических зон /на грани-  
це раздела/

BER /beam-forming  
region/  
область формирования лу-  
ча /в электронно-луче-  
вом приборе/

BGE /below(band) gate  
excitation/  
возбуждение с энергетиче-  
скими переходами,  
меньшими ширины запре-  
щенной зоны

BHJT /bipolar hetero-  
junction transistor/  
биполярный транзистор с  
гетеропереходом

BHS /buried hetero-  
structure stripe la-  
ser/  
лазерный диод со скрытой  
полосковой гетерострукту-  
рой

BIB-IR /blocked impu-  
rity-band IR-detector/  
приемник ИК-излучения с  
блокированной примесной  
зоной

BICFET /buried isola-  
tion channel FET/  
ПТ с каналом со скрытой  
изоляция

BICFET /bipolar inver-  
sion-channel FET/  
биполярный ПТ с инвер-  
сионным каналом

BiCMOS (BICMOS) /bi-  
polar CMOS/  
биполярная КМОП /струк-  
тура, технология/

BIDMOS /bipolar +  
double-diffusion MOS/  
ИС на основе биполярных  
транзисторов и двухдиф-  
фузионных МОП-ПТ

BIDFET /bipolar+double-  
diffusion FET/  
ИС на основе биполярных  
транзисторов и двухдиф-  
фузионных МОП-ПТ

BIG LD /bundle-integ-  
rated-guide laser  
diode/  
лазерный диод с интер-  
вальным пучковым свето-  
водом

BIIAS /bipolar phototran-  
sistor + laser/  
монолитная интеграция  
биполярного фототранзис-  
тора с лазерным диодом

BIT /bipolar integ-  
rated technology/  
технология биполярных  
ИС

BJB-DBR /butt-jointed  
built-in distributed  
Bragg reflector laser/  
лазерный диод со встро-  
енным впритык распреде-  
ленным брэгговским отра-  
жателем

BLDD /buried lightly  
doped drain FET/  
ПТ со скрытой слабеле-  
гированной областью  
стока

BLT /back-of-the ca-  
thode light-triggered  
thyatron/, /back-  
lighted thyatron/

Фототиратрон с /лазер-  
ным/ освещением тыльной  
стороны катода

BLIC /bipolar-MOS  
line interface cir-  
cuit/  
линейная схема сопряже-  
ния на биполярной МОП-  
ИС

BMFET /bipolar-mode  
FET/  
ПТ в биполярном режиме

BOD /bistable optical  
device/  
бистабильный оптический  
прибор

BOL /beginning-of-  
life/  
начало срока службы

BOM /built on mask/  
формирование рисунка  
/маски/ на поверхности  
позитивного фоторезиста

BORSHT /battery-feed,  
overvoltage-protec-  
tion, ringing, super-  
vision, hybrid and  
testing/ LSI

БИС с батарейным питани-  
ем, защитой от перена-  
пряжений, прозванивает-  
ся, тестируется, гибрид-  
ная

BOX /buried oxide/  
скрытый слой оксида

BPCD /back-gated pho-  
toconductive detec-  
tor/

фотоприемник с тыловым  
затвором Шоттки

BPLDD /buried p-layer  
lightly doped drain/  
скрытая слаболегированная  
p-область стока

BPR /beam pressure-  
ratio/  
отношение интенсивностей  
молекулярных потоков ком-  
понентов /в молекулярно-  
лучевой эпитаксии полу-  
проводниковых соединений/

BP-SAINT FET /buried  
p-layer self-aligned  
implantation for n -  
layer technology FET/  
технология n<sup>+</sup>-канального  
ПТ со скрытым p-слоем с  
самосовмещением и ионной  
имплантацией

BPT /bipolar tran-  
sistor/  
биполярный транзистор

BPT /bipolar photo-  
transistor/  
биполярный фототранзис-  
тор

Bragg-EXAFS /Bragg-  
extended X-ray ab-  
sorption fine struc-  
ture/  
метод исследования тон-  
кой структуры протяжен-  
ных спектров рентгеновс-  
кого поглощения в режиме  
брегговского отражения

BRS /buried ridge-  
stripe laser/  
лазерный диод со скры-  
той реберной полоско-  
вой структурой

BSE /buried storage  
electrode/  
скрытый электрод памяти

BT /bias-temperature  
test/  
термополевые испытания

BTB /bumped-tape bon-  
ding/  
присоединение /кристал-  
лов/ к столбиковым выво-  
дам на ленточном носите-  
ле

BTE /Boltzmann tran-  
sport equation/  
уравнение переноса Больц-  
мана

BUD /bulk unipolar  
diode/  
диод с внутренним унипо-  
лярным барьером  
см. BBD

BWO /backward-wave  
oscillation/  
генерация обратной волны

## С

CAD /chemical anor-  
ganic deposition/  
химическое осаждение из  
неорганических соединений

CAPD /conventional  
avalanche photodiode/  
традиционный лавинный  
фотодиод

CARIBE /chemically-  
assisted reactive  
ion-beam etching/  
реактивное ионно-лучевое  
травление с химическим  
действием

CBD /chemical bath deposition/ химическое осаждение /би-нарных соединений/ из раствора-расплава	CCL /color center laser/ лазер на центрах окрашивания
CBE /combined beam epitaxy/ комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и химического осаждения из паровой фазы металлоорганических соединений	C-channel MCP /curvilinear channel microchannel plate/ микроканальная пластина с изогнутыми каналами
CBH /circular buried heterostructure/ круглая зарощенная гетероструктура	CCTWT /coupled-cavity travelling-wave tube/ ЛБВ со связанным резонатором
CBIM /convergent-beam imaging/ получение изображения с помощью сходящегося пучка	CD /critical dimension/ критический размер /при литографии/
CBM /conduction band minimum/ минимум /дно/ зоны проводимости	CD /co-deposited/ полученный совместным осаждением
CCC /copper chip carrier/ медный кристаллодержатель	CDE /chemical dry etching/ химическое сухое травление
CCC /cross-coupled-cavity laser/ лазер с перекрестно-связанным резонатором	CDM /carrier-domain magnetometer/ магнетометр на эффекте Ганна
C <sup>2</sup> -DLTS /CCDLTS/ /constant-capacity deep level transient spectroscopy/ техника релаксационной спектроскопии глубоких уровней в режиме постоянной емкости	CDQW /coupled double quantum well/ структура из двух связанных квантовых ям
	CDS /cathode dark space/ катодное темное пространство /в газовом разряде/

CDS /comprehensive display system/  
легкочитаемая дисплейная система

CDW /charge density wave/  
волна плотности заряда

CEL /contrast-enhancement layer/  
слой, усиливающий контраст

CFD /correction of focus and deflection/  
коррекция фокусировки и отклонения /магнитной отклоняющей системы с самосведением/

CFD /crossed-field device/  
СВЧ-прибор со скрещенными полями

CFO /crossed-field oscillator/  
СВЧ-генератор со скрещенными полями /М-типа/

CFRP /carbon fibre reinforced plastics/  
пластик, армированный углеродным волокном

CGS /chalcogenide glassy semiconductor/  
стекловидный халькогенидный полупроводник  
см. также ChVS

CHC /charge handling capacity/  
зарядоуправляемая емкость

CHIG FET /complementary heterostructure insulated-gate FET/

комплементарный полевой гетеротранзистор с изолированным затвором

CHINT /charge-injection transistor/  
транзистор с инжекцией зарядов /инжекционный транзистор/

CHIRP /coherent heterointerfaces for reflection and penetration/  
периодическая структура /сверхрешетка/ с когерентными гетерограницами для отражения и проникновения носителей заряда

ChVS /chalcogenide vitreous semiconductor/  
см. CGS

CIDS /copper-indium diselenide (CuInSe<sub>2</sub>)/  
диселенид индия-меди /материал для солнечных элементов/

CIM /computer integrated manufacturing/  
машинная технология

CIRIC /carrier induced refractive index change/  
индуцированное носителями изменение показателя преломления

CIS /copper indium diselenide/  
см. CIDS

CM /constricted mesa/  
сжатая мезаструктура

CMF /compositionally modulated film/ пленка с модуляцией состава	COMD /catastrophic optical mirror damage/ катастрофическое оптическое повреждение зеркала /резонатора лазера/
CMF /compressed magnetic field/ сжатое магнитное поле	COMPOSITE /complete modeling program of silicon technology/ комплексная программа моделирования кремниевой технологии ИС
CMF-MS /compressed magnetic-field magnetron sputtering/ магнетронное распыление в сжатом магнитном поле	COO /contacts over oxide/ контакты поверх слоя оксида
CMS /crossatron modulator switch/ плазменный переключатель /газоразрядный переключатель со скрещенными полями/	COO MOSFET /contacts over oxide/ MOS FET МОП-ПТ с контактами исток-сток поверх слоя оксида
COB /chip-on-board/ assembly узел "кристалл на плате"	COTU /complex optimized tube-yoke/ оптимизированный комплект электронно-лучевая трубка - система магнитной фокусировки
COD /chemical organic deposition/ химическое осаждение из органического соединения	CP /chalcopyrite structure/ структура халькопирита
CODE /comprand and orientation dependent epitaxy/ парофазная эпитаксия с зависимостью скорости роста от состава газовой смеси и ориентации подложки	CPE /chemical-phase epitaxy/ химическая парофазная эпитаксия
COLIDAR /coherent-light detecting and ranging/ лазерная локация	CPM /constant photocurrent method/ метод определения плотности дефектов по спектрам фотопроводимости и оптического поглощения
	CPM /colliding-pulse mode-locked laser/

лазер с перекрывающимися импульсами излучения в режиме синхронизации мод

CPPA /charged particle activation analysis/ активационный анализ заряженных частиц

CPT /charge priming transfer/ секция ускорения переноса зарядов

CPW /coplanar waveguides/ копланарные волноводы

CQFP /ceramic quad flat package/ плоский керамический четырехэлементный корпус

COW /coupled quantum wells/ связанные квантовые ямы

CR /carbothermic reduction/ метод получения Si карбо-термическим восстановлением  $SiO_2$

CR /cooling rate/ скорость охлаждения /в методе жидкофазной эпитаксии/

CROSS HOMO CVD /cross homogeneous chemical vapour deposition/ модификация метода HOMO CVD в реакторе со скрещенными направлениями градиента температуры и потока газа

CSC /compound semiconductor/ полупроводниковое соединение

CSCTT /close-spaced chemical transport technique/

осаждение методом химического переноса при малом расстоянии источник-подложка

CSP /channeled strip planar laser/ планарный полосковый лазерный диод с каналом в подложке

CSS /close-spaced sublimation/ сублимация в замкнутом объеме при малом расстоянии источник-подложка

CSST /circular-scan streak tube/ хронографический электронно-оптический преобразователь с круговой разверткой

CSVT /close-spaced vapor transport/ метод транспортных реакций в замкнутом объеме

CTE /coefficient of thermal expansion/ коэффициент термического расширения

CTF /conductive transparent film/ прозрачная проводящая пленка

CTJ /coaxial transverse junction/ коаксиальный поперечный переход

CTL CVD /catalytic chemical vapour deposition/

химическое осаждение из паровой фазы с применением нагреваемого катализатора

CVC /current-voltage characteristic/  
вольт-амперная характеристика /ВАХ/

CVD OLL /chemical vapour deposition on liquid layer/  
химическое осаждение из паровой фазы на жидкий слой /напр., Si на слой расплавленного Al на стекле/

CVE /combination of vapour elements/  
вариант метода химического осаждения из паровой фазы с прямым смешиванием паров компонентов /напр., CdTe/

CVE /chemical vapour epitaxy/  
химическая парофазная эпитаксия /с прямым смешиванием паров компонентов/

CVI /chemical vapour infiltration/  
химическая паровая инфильтрация /напр., в пористый углерод/

CWLA /continuous-wave laser annealing/  
отжиг излучением лазера непрерывного действия

CZS /CdZnS/  
сульфид цинка-кадмия

## D

DAC /dynamic astigmatism control/  
динамическая коррекция астигматизма

DANC /drain avalanche hot carrier/  
лавинное умножение горячих носителей на стоке

DAP LC /deformation aligned phase liquid crystal/  
жидкий кристалл с деформацией ориентированной фазы

DARSS /diode array rapid-scan spectrometry/  
спектрометрия с быстрым сканированием диодной матрицы

DB /dangling bonds/  
болтающиеся связи

DBCC /direct-bond copper chip carrier/  
медный кристаллоноситель с прямой приваркой /контактов/

DBCCD /deep buried channel CCD/  
ПЗС с глубоким скрытым каналом

DBQW /double-barrier quantum well/  
квантовая яма с двойным барьером

DCB /direct copper bonding/

прямое соединение через медные контакты

DCEMS /depth-selective conversion electron Mössbauer spectroscopy/

избирательная по глубине конверсионная электронная мессбауэровская спектроскопия

DCP /direct current pumped laser/

лазер с накачкой постоянным током

DCRC /direct current resistance-capacity/

измерение на постоянном токе произведения сопротивления на емкость

DD /2-D/ /double-diffused/

с двойной диффузией

DEIS /dual electron injector structure/

инжектор двойного пучка электронов

DEPLI /depletion region lateral isolation/

боковая изоляция обедненной области

DERIE /double-source excited reactive ion etching/

реактивное ионное травление с использованием двух источников /для контроля формы канавки/

DES /diethylsulfide/

диэтилсульфид

DESe /diethylselenide/

диэтилселенид

DEZ /diethylzinc/

диэтилцинк

DETC /doped face trench capacitor/

конденсатор в виде канавки с легированным дном

DHBT /double-heterojunction bipolar transistor/

биполярный транзистор с двойной гетероструктурой

DHS /double heterostructure/

двойная гетероструктура

DI /dielectric isolation/

изоляция слоем диэлектрика

DI-BCDMOS /dielectrically isolated bipolar CMOS-DMOS/

комбинация биполярной КМОП и ДМОП-структур с диэлектрической изоляцией

DIBE /defect-induced bound excitons/

индуцированные дефектами связанные экситоны

3-D IC /three-dimensional IC/

трехмерная ИС

DID /dopant impurity diffusion/

процесс диффузии легирующей примеси /из покрывающего слоя/

DID /double-implanted design/  
рисунок /межсоединений/, выполненный двукратной имплантацией

DID /diffusion-induced disordering/  
индуцированное диффузией разупорядочение структуры

DIFLOX /diffused layer controlled floating-gate-type cell with thin oxide/  
МОП-структура с плавающим затвором и тонким слоем оксида, управляемая изменением толщины диффузионного слоя

DIMPATT /distributed IMPATT/  
распределенный ЛПД

DIGM /diffusion-induced grain boundary migration/  
миграция границ зерен, индуцированная диффузией

DIP /digital image processing/  
цифровая обработка изображения

DLE /deep level emission/  
люминесценция с участием глубоких уровней /глубокоуровневая люминесценция/

DMCd /dimethylcadmium/  
диметилкадмий

DME /detector materials engineering/  
технология материалов детекторного качества /химических соединений высокой чистоты и однородности состава/

DMS /diluted magnetic semiconductor/  
полупроводник со слабыми магнитными свойствами

DNP /direct nitride passivated base surface/  
поверхность базы, пассивированная прямым нитрированием

DOES /double-heterostructure optoelectronic switch/  
оптоэлектронный переключатель с двойной гетероструктурой

DOLS /density of localized states/  
плотность локализованных состояний

DOT /domain-tip propagation/  
продвижение вершины домена

2D /double-diffusion/  
двукратный процесс диффузии

DQE /detectiv quantum efficiency/  
эффективность преобразования рентгеновского излучения в электроны /в фотографической пленке/

DS /directional solidification/  
направленное отверждение

DSM /dielectrically shielded microstrip/  
микрорословковая структура, скрытая слоем диэлектрика

D-SIN LCD /double-layered supertwisted nematic liquid-crystal display/  
жидкокристаллический индикатор на основе двуслойного супертвистированного нематика

DT /direct tunneling/  
прямое туннелирование

DTA /differential thermal analysis/  
дифференциальный термoанализ /ДТА/

DTC /deposition thickness controller/  
регулятор толщины нанесенного слоя

DuoPIGatron /double-chamber Penning-ionization gauge/  
дуопигатрон /двухкамерный магниторазрядный манометр или сильноточный источник ионов/

DUV /deep ultra-violet/  
глубокий ультрафиолет

DX /donor-like center/  
донороподобный центр

DZ /diode Zener/  
стабилитрон

## Е

EAD /electroabsorption avalanche detector/  
лавинный детектор электропоглощения

EB CVD /electron beam chemical vapour deposition/  
химическое осаждение из паровой фазы, стимулированное электронно-лучевым облучением

EBD /electron-beam doping/  
электронно-лучевая имплантация примеси /из нанесенного на поверхность слоя/

EBE /electron beam exposure epitaxy/  
эпитаксия с электронно-лучевым облучением

EBEP /electron beam excited plasma/  
плазма с электронно-лучевым возбуждением

EBIS /electron beam /pattern/ inspection system/  
система электронно-лучевого контроля рисунка ИС

EBPG /electron beam pattern generator/  
электронно-лучевая система нанесения рисунка

EC /eutectic composites/  
составляющие эвтектики

ECB /electrically controlled birefringence/  
электрически управляемое двулучепреломление

ECD /electron cyclotron deposition/  
осаждение методом электронного циклотронного резонанса /в плазме/

ECH /electron cyclotron heating/  
нагрев /плазмы/ методом электронного циклотронного резонанса

ECI /electron channeling imaging/  
визуализация картины каналирования электронов

ECP /electron-channeling pattern/  
картина каналирования электронов /получаемая при электронно-лучевом сканировании поверхности/

ECR PCVD /electron cyclotron resonance plasma chemical vapour deposition/  
плазмохимическое осаждение из паровой фазы в режиме электронного циклотронного резонанса

ECS FET /evaporated chemical sensitive FET/  
пленочный хемочувствительный ПТ

EDMIn /ethylindium/  
этилдиметилиндий

EDC /electrooptic directional coupler/  
электрооптическая пара с направленной связью

EDX /energy-dispersive X-ray microanalysis/  
энергодисперсионный рентгеновский микроанализ

EDXS /energy-dispersive X-ray spectroscopy/  
энергодисперсионная спектроскопия рентгеновского излучения

EE /explosive emission/  
см. EEE

EEE /explosive electron emission/  
взрывная электронная эмиссия

EELFS /extended electron energy loss fine structure/  
тонкая структура протяженных спектров потерь энергии электронов

EEL /electronically excited laser/  
лазер с электронной накачкой

EELFS /extended-energy  
loss fine structure/  
см. EЕЕLFS

EEODS /experimental  
electron-optical de-  
montable system/  
разборная камера для ис-  
следования электронно-  
оптических систем

EFE /enhanced field  
emission/  
усиленная полевая эмис-  
сия

EFSA /error function  
superposition approx-  
imation/  
метод суперпозиции ин-  
тегралов вероятности  
ошибок /для оценки раз-  
решения при глубинном  
профилировании/

EG-Si /electronic-  
grade/ Si  
кремний электронного  
качества /пригодный  
для создания электрон-  
ных компонентов/

EG /extrinsic gette-  
ring/  
геттерирование примеси

EGM /epitaxial  
growth by melting/  
эпитаксиальное выращи-  
вание плавлением

ENEHI /electron-hole  
exchange interaction/  
обменное взаимодейст-  
вие электрон-дырка

ENP /electron-hole  
plasma/  
электронно-дырочная  
плазма

EIS /electrolyte-in-  
sulator-semiconduc-  
tor/  
/ионночувствительный/  
переход электролит /  
диэлектрик / полупровод-  
ник

ELE /electrolumines-  
cent light emitter/  
электролюминесцентный  
излучатель /ЭЛИ/

ELH /electrolumines-  
cent halogen lamp/  
электролюминесцентная  
лампа на парах галоген-  
нов

ELOWIG /electron beam-  
laser beam-wolfram-  
inert gas/ arc mel-  
ting/  
процесс поверхностной  
обработки с использо-  
ванием электронного и  
лазерного пучков и дуго-  
вого разряда в инертном  
газе с вольфрамовым ка-  
тодом

ELPE /electro-liquid  
phase epitaxy/  
электрожидкофазная эпи-  
таксия /ЭЖЭ/  
см. также LPPE

EM /electromigration/  
электромиграция

EM /electromodula-  
tion/  
электромультипликация

EMA /effective mass  
approximation/  
приближение эффективной  
массы

EMFAPS /exploding-metal-film-anode plasma source/  
источник плазмы с взрывающимся металлопленочным анодом

EMI /electromagnetic interference/  
интерференция электромагнитных волн

EMIRS /electromodulated IR spectroscopy/  
электромодуляционная спектроскопия ИК-излучения

EMT /effective mass theory/  
теория эффективной массы

EOS /electrooptical sampling/  
электрооптическое тестирование

EPE /electron-photon emission/  
электрон-фотонная эмиссия

EPES /elastic peak electron spectroscopy/  
спектроскопия пиков упругого рассеяния электронов

EPES /electron-photon emission spectroscopy/  
спектроскопия электрон-фотонной эмиссии

EPIC /эпоxy-исocyanate resin/  
эпоксидная смола на основе изоцианата

EPIC /enhanced performance implanted CMOS/  
КМОП ИС с улучшенными параметрами, изготовленная с применением ионной имплантации

EPR Si /electron powder ribbon Si/  
ленточный поликристаллический Si, полученный рекристаллизацией порошка электронным облучением

ER /electroreflectance  
электроотражение

ERD/A//elastic-recoil detection analysis/  
спектроскопия атомов отдачи /при упругих соударениях быстрых ионов/

ERPES /energy-resolved photoemission spectroscopy/  
фотоэлектронная спектроскопия с высоким энергетическим разрешением

ERS /electroreflection spectroscopy/  
спектроскопия электроотражения

ESC /elementary semiconductor/  
элементарный полупроводник

ESD /evaporative surface decomposition/

осаждение /Si/ методом  
высокотемпературного  
поверхностного разло-  
жения /силана/

ESP /electron spin-  
polarization/  
спин-поляризация электро-  
нов

ETD /easy to drive  
device/  
прибор с малыми потерями  
на переключение

ETR /energy transfer  
rate/  
скорость переноса энер-  
гии

EXAD /electron-beam  
generated X-ray absorp-  
tion/  
поглощение рентгеновско-  
го излучения, возбужден-  
ного электронным облу-  
чением

EXFAS /extended fine  
Auger structure/  
протяженная тонкая  
структура оже-пиков

## Ф

FA /furnace annealing/  
отжиг в печи

FABS /fast-atom-  
bombardment spect-  
roscopy/  
спектроскопия ионов, вы-  
ходящих под действием  
бомбардировки мишени  
быстрыми атомами

FAP /field-assisted  
photoemission/  
фотополевая эмиссия

FAT /flexible array  
technik/  
техника гибких матриц

FBN /flat-surface  
buried-heterostruc-  
ture/  
плоская выращенная гетер-  
роструктура

FBR /fluidized-bed  
reactor/  
реактор со сжиженным ка-  
налом /для получения  
кремния из силана/

FCC /folded capacitor  
cell/  
динамическая ячейка с  
целевым конденсатором

FDMS /field desorp-  
tion mass-spectro-  
metry/  
масс-спектрометрия поле-  
вой десорбции

FE /free exciton/  
свободный экситон

FEA /field emitter  
array/  
решетка полевых эмитте-  
ров

FEC /ferroelectric  
ceramics/  
сегнетокерамика

FECO /fringes of  
equal chromatic order/  
метод измерения толщины  
тонких пленок по интерфе-  
ренционным полосам одина-  
кового хроматического по-  
рядка /метод Толански/

FEE /field-enhanced  
emission/  
усиленная полем эмиссия

FESAM /field emission scanning Anger microscop/	масс-спектрометрия полевой ионной эмиссии
автоэмиссионный растровый оже-электронный микроскоп	FIP /fluorescent indicator panel/ вакуумный люминесцентный индикатор
FETOM /FET optical modulator/	FIR /focused ion ray/ сфокусированный пучок ионов
оптический модулятор на полевом транзисторе	FIRPC /far IR photoconductivity/ фотопроводимость в далекой ИК-области спектра
FE UDT /floating electrodes unidirectional transducer/	FIST /focused-ion-striped transistor/ ПТ с полосковой структурой, выполненной с помощью сфокусированного ионного пучка
однонаправленный преобразователь /ПАВ/ с плавающими электродами	FIT-CCD /fram-inter-line transfer CCD imager/ преобразователь изображения на ПЗС с кадровым и межстрочным переносом
FF /flip-flop/ метод перевернутого кристалла	FLC /ferroelectric liquid crystal/ сегнетоэлектрический жидкий кристалл
FIB-DBR laser /focused ion beam implanted grating distributed Bragg-reflector/ laser/	FLP /Fermi-level pinning/ фиксирование /пиннинг/ уровня Ферми
лазерный диод с распределенным брэгговским отражателем и дифракционной решеткой, изготовленной методом имплантации сфокусированных ионов	FLS /fractional layer superlattice/ ступенчатая сверхрешетка
FIBE /focused ion beam etching/ травление сфокусированным ионным пучком	FLSP /fine-line-spot position sensitive photodetector/
FIBI /focused ion beam implantation/ ионная имплантация с использованием сфокусированного ионного пучка	
FIEMS /field ion emission mass-spectrometry/	

фотоприемник с высокой  
позиционной чувствитель-  
ностью и высоким прост-  
ранственным разрешением

FME /flow-rate modu-  
lation epitaxy/

эпитаксия с модуляцией  
скоростей потоков газов  
/модуляционная парофаз-  
ная эпитаксия/

F-N /Fowler-Nordheim/  
закон Фаулера-Нордгейма

FOG /fiber optic  
gyro/

волоконно-оптический ги-  
роскоп

FOLZ /first order  
Laue zone/

область дифракционного  
/лауэвского/ отражения  
первого порядка

FOT /fiber-optic  
transceiver/

волоконно-оптический  
приемопередатчик

FOX /field oxide/  
/защитный/ слой оксида

FPLA /Fabri-Perot  
laser amplifier/

лазерный усилитель Фаб-  
ри-Перо

FPPLCC /fine pitch  
plastic chip carrier/  
пластмассовый кристал-  
лодержатель с малым ша-  
гом выводов

FRED FET /fast-recove-  
ry reverse diode FET/  
ПТ с затвором в виде бы-  
стродействующего обратно-

смещенного диода /новый  
тип мощного МОП-ПТ фир-  
мы Siemens/

FS-CRT /flat square  
CRT/

ЭЛТ с уплотненным пря-  
моугольным экраном

FS CRT /full square  
CRT/

ЭЛТ с экраном с пол-  
ностью спрямленными уг-  
лами

FSA /flat-plate  
solar array/

плоская панель солнеч-  
ных элементов /солнеч-  
ная батарея/

FT-CCD /fram-trans-  
fer CCD imager/

преобразователь изобра-  
жения на ПЗС с кадро-  
вым переносом

FT ICR /Fourier-  
transform ion cyclo-  
tron resonance spect-  
rometer/

Фурье-спектрометр на  
основе ионного цикло-  
тронного резонанса

FTO /fluorine-doped  
tin oxide/

легированный фтором ок-  
сид олова /SnO<sub>2</sub>:F/

FZ /floating-zone/  
метод плавающей зоны

FZ-Si /floating zone-  
Si/

кремний, выращенный ме-  
тодом плавающей зоны

FZP /Fresnel-zone  
plate/  
пластинка с зонами Френеля

## G

GA /gate array/  
матрица логических элементов

GC /gas counter/  
газоразрядный счетчик частиц

GCE /grating-coupled  
emission laser/  
лазерный диод с дифракционной связью

GCPD /gate-controlled  
photodiode/  
фотодиод с управляющим затвором

GD CVD /gas discharge  
chemical vapour deposition/  
химическое осаждение из паровой фазы в условиях газового разряда

GDES /glow discharge  
emission spectroscopy/  
спектроскопия свечения тлеющего разряда

GDMS /glow discharge  
mass-spectrometry/  
масс-спектрометрия тлеющего разряда

GDOS /gap density  
of states/  
плотность состояний в запрещенной зоне

GECL /grating external-cavity laser/

лазер с дифракционной решеткой в качестве внешнего резонатора

GFEL /gas-loaded  
free-electron laser/  
лазер на свободных электронах с газовой нагрузкой

GFRP /glass fibre  
reinforced plastic/  
пластмасса, армированная стекловолокном, стеклопластик

GGG /gadolinium-gallium garnet/  
гадолиниво-галлиевый гранат /лазерный материал/

GIC /graphite intercalation compound/  
графитосодержащий компаунд

GILD /gas-immersion  
laser doping/  
лазерное легирование из газовой среды

GILD /gas immersion  
laser diffusion/  
диффузия из газовой среды, стимулированная лазерным облучением

GIS /grazing incidence spectrometer/  
спектрометр со скольльзящим падением /пучка/

GKA /gyroklystron  
amplifier/  
гироклистрон

GOI /Ge-on-insulator/  
структура германий-на диэлектрике /ГНД/

GSM /gradient solidification method/  
метод градиентного отверждения

GSMBE /gas source molecular-beam epitaxy/  
молекулярно-лучевая эпитаксия с газообразным источником

GT UDT /group-type unidirectional transducer/  
однонаправленный преобразователь /ПАВ/ группового типа

## Н

HAC-LC /hybrid-aligned cholesteric liquid crystal/  
ячейка холестерического жидкого кристалла, совмещаемая с гибридной ИС

HADOX /high-angle double-crystal X-ray diffraction/  
двухкристальная рентгеновская дифрактометрия

HAN-LC /hybrid-aligned nematic liquid crystal/  
ячейка нематического жидкого кристалла, совмещаемая с гибридной ИС

HASR /hole-and-slot resonator/  
резонатор со структурой щель-отверстие

HAST /highly accelerated stress tests/  
тесты ускоренных испытаний

NB /half-barrier height/  
полувысота барьера

NBE /high birefringence effect/  
высокое /сильное/ двулучепреломление

NBG /horisontal Bridgman growth/  
выращивание горизонтальным методом Бриджмена

NBJT /heterostructure bipolar-junction transistor/  
биполярный гетеротранзистор

NBPT /heterostructure bipolar phototransistor/  
биполярный фототранзистор с гетеропереходом

NCC /hermetic chip carrier/  
герметизированный кристаллодержатель

N-CCD /horisontal CCD register/  
горизонтальный ПЭС-регистр

NCCIS /hollow cold cathode ion source/  
ионный источник с полым холодным катодом

NCD /hollow-cathode discharge/  
разряд с полым катодом

HCE /hollow-cathode effect/  
эффект полого катода

HCIS /hollow-cathode ion source/  
ионный источник с полым катодом

HCT /high-speed CMOS with TTL levels/  
быстродействующая КМОП ИС, совместимая по уровням с ТТЛ

HC VPE /hybrid-chlorid vapour-phase epitaxy/  
гидрид-хлоридная паровая эпитаксия /ГХ-ПФЭ/

HDIL-CCD /high-definition interline CCD imager/  
преобразователь изображения с высокой четкостью на ПЗС с межстрочным переносом

HDR /high-deposition-rate/  
быстрое осаждение

HEB /high current electron beam/  
сильноточный электронный пучок

HEC /hot-electron channeling/  
каналирование горячих электронов

HEIP /hot-electron induced punchthrough/  
индуцированное горячими электронами прожигания отверстий

HEMP /high altitude electromagnetic pulse/  
высокий импульс электромагнитного излучения

HFB /helical feedback спиральная система обратной связи

HFET /heterostructure FET/  
гетероструктурный ПТ /ПТ с гетероструктурным затвором/

HFKE /high-frequency Kerr-effect/  
высокочастотный эффект Керра

HHC /hot hollow cathode/  
накаленный полый катод

HI /heavy ion/  
тяжелый ион

HIBRICON /high-brightness cinescop/  
кинескоп с высокой яркостью изображения /хайбрайкон/

Hi-CMOS /hight performance CMOS/  
высококачественная КМОП ИС

HIF /heavy-ion fusion/  
термоядерный синтез с использованием тяжелых ионов

HIFET /heterointerface FET/  
полевой транзистор с гетерограницей

HIGFET /hetero-  
structure insulated  
gate FET/  
полевой транзистор с ге-  
тероструктурным затвором

HIRBS /heavy-ion  
Rutherford backseat-  
tering spectroscopy/  
спектроскопия обратного  
резерфордского рассея-  
ния тяжелых ионов

HIT /high-density  
isolation technology/  
технология изоляции эле-  
ментов БИС высокой плот-  
ности /канавками, запол-  
ненными SiO<sub>2</sub>/

H MOS-U /ultimate  
high-performance MOS/  
сверхвысококачественная  
МОП ИС

HMR /high mass reso-  
lution/  
высокое разрешение по  
массам /в масс-спектро-  
метрии/

HNA /holographic  
nanometer align-  
ment/  
голографическое совмеще-  
ние с точностью до 1 на-  
нометра

HOLZ /high-order  
Laue zone/  
область дифракционного  
/лауэвского/ отражения  
высокого порядка

HOMO CVD /homogeneous  
chemical vapour de-  
position/

гомогенное химическое  
осаждение из паровой  
фазы

HOPG /highly oriented  
pyrolytic graphite/  
высокоориентированный  
пирографит /со сколотой  
поверхностью/

HPGS /high pressure  
gas source/  
источник газа высокого  
давления

HPSAC /high-perfor-  
mance silicided amor-  
phous-silicon contact/  
высококачественный кон-  
такт из аморфного крем-  
ния, покрытого слоем  
силицида

HR CVD /hydrogen-ra-  
dical-enhanced chi-  
mical vapour deposi-  
tion/

химическое осаждение из  
паровой фазы, усиленное  
введением радикалов во-  
дорода

HRD /high rate depo-  
sition/  
быстрое осаждение

HREB /high current  
relativistic elect-  
ron beam/  
сильноточный релятивист-  
ский электронный пучок  
/СРЭП/

HRG /horisontal rib-  
bon growth/

горизонтальное выращивание ленточного материала

HTB /high-temperature-bias/

режим повышенной температуры и подачи смещения

HTR /high-temperature passivation/

высокотемпературная пассивация

HTS /high-temperature solution/

высокотемпературный раствор

HVIC /high-voltage IC/

высоковольтная ИС

## I

IAP /imaging atom probe/

атомный зонд с системой формирования ионного изображения

IBC /interdigitated back contacts/

встречно-штыревые /гребенчатые/ тыловые контакты

IBC-IR /impurity band conduction IR detector/

приемник ИК-излучения с проводимостью по примесной зоне

IBIEC /ion beam induced epitaxial crystallization/

эпитаксиальная кристаллизация, индуцированная ионно-лучевой обработкой

IBJT /integrated bipolar-junction transistor/

интегральный биполярный транзистор

IBPG /ion beam pattern generator/

ионно-лучевое устройство для нанесения рисунка /разводки/

IBT /inversion-base bipolar transistor/ биполярный транзистор с инверсионной базой

ICBD /ionized cluster beam deposition/

осаждение из пучка ионизированных кластеров

ICISS /impact-collision ion scattering spectroscopy/

лобовая ионно-рассеивательная спектроскопия /с рассеиванием на углы  $\sim 180^\circ$ /

ICLT /IC laser testing/

лазерное тестирование ИС /фирма IBM/

ICPS /inductively-coupled plasma spectroscopy/

спектроскопия индуктивно связанной плазмы

ICRF /ion cyclotron range of frequencies/

частотный диапазон ионного циклотронного резонанса

- ICSP /index-guided inverted channeled-substrate planar laser/  
 планарный лазерный диод с каналом в подложке и волноводом с обратным скачком показателя преломления
- IDP /ion-depth profiling/  
 профилирование глубинного распределения ионов /при ионном распылении/
- IFEL /inverse free-electron laser/  
 инверсный лазер на свободных электронах /с передачей энергии от лазерного луча к электронному/
- IG /intrinsic gettering/  
 внутреннее геттерирование
- IGBT /improved-gate bipolar transistor/  
 биполярный транзистор с улучшенным затвором
- IGBT /insulated-gate bipolar transistor/  
 биполярный транзистор с изолированным затвором
- IID /impurity-induced disordering/  
 индуцированное примесью разупорядочения /решетки/
- IIDS /image intensifier dissector system/  
 диссекторный усилитель яркости изображения
- IILD /impurity-induced layer disordering/  
 индуцированное примесями разупорядочение слоев /в сверхрешетках/
- IIPS /ion implanted planar Si detector/  
 ионно-легированный планарный Si детектор /применяемой в спектроскопии заряженных частиц/
- I<sup>2</sup>S /index-guided inner-stripe/  
 встроенная полосковая структура с диэлектрическим волноводом
- IL CCD /interline transfer CCD/  
 ПЗС со строчным переносом
- ILPE /isothermal liquid-phase epitaxy/  
 изотермическая жидкофазная эпитаксия
- IMOD FET /inverted modulation-doped FET/  
 инверсионный модуляционно-легированный ПТ
- IMP /inter-diffused multilayer process/  
 процесс создания многослойных структур методом внутренней диффузии
- IMPAT /implanted advanced transistor/  
 усовершенствованный транзистор, полученный методом ионной имплантации

IMSM /interdigitated MSM/ гребенчатая МПМ-структура	IRPD /IR photodesorption/ фотодесорбция под действием ИК-излучения
IOC /integral optic component/ компонент интегральной оптики	IRRAS /IR reflection-absorption spectroscopy/ спектроскопия отражения-поглощения ИК-излучения
IOEC /integral optoelectronic circuit/ оптоэлектронная ИС	IRS /IR-soldering/ пайка ИК-облучением
IOS /ion source/ ионный источник	I to S /image to signals transfer/ преобразование изображения в электрические сигналы
IPC /integrated passive cavity/ интегральный пассивный резонатор	ISOCMOS /isolated Si-oxide-gate CMOS/ КМОП-структура с поликремниевым затвором и оксидной изоляцией
IPE /internal photoemission/ внутренняя фотоэмиссия	ISS /ion scattering spectroscopy/ спектроскопия рассеянных ионов /ионно-рассеивательная спектроскопия/
IPEC /internal photoemission current/ ток внутренней фотоэмиссии	ISTA /in-situ thermal annealing/ термический отжиг в процессе эпитаксии
IPL /iodine photo-dissociation laser/ фотодиссационный лазер на парах иода	IT /interdigitated transducer/ преобразователь /ПАВ/ с встречноштыревыми электродами
IPLM /ion projection lithography machine/ аппаратура для проекционной ионной литографии	ITC /inverted thermal conversion/ обратное термопреобразование /из проводящего в полупроводящее состояние/ в процессе отжига
IRAS /IR absorption spectroscopy/ спектроскопия ИК-поглощения	
IRMPD /IR-multiple-photon dissociation/ ИК-многоквантовая диссоциация	

ITM /implantation  
through metal/  
имплантация сквозь слой  
металла

ITO PR /intermediate  
temperature opera-  
tion photoresistor/  
фоторезистор, охлаждае-  
мый жидким фреоном /195K/

ITS /ionic thermo-  
metric sensor/  
ионный термометрический  
датчик

IVC /current-voltage  
characteristic/  
вольт-амперная характе-  
ристика /ВАХ/

IVE /interdigital  
vertical-electrode  
system/  
установка со встречно-  
штыревыми вертикальными  
электродами /для плазмо-  
химического осаждения/

IVEC /isolation-  
merged vertical ca-  
pacitor/  
вертикальный конденсатор  
с комбинированной сро-  
щенной изоляцией

IXPS /internal X-ray  
photoemission spect-  
roscopy/  
рентгеновская фотоэмис-  
сионная спектроскопия  
с внутренним возбужде-  
нием /электронной бом-  
бардировкой/ рентге-  
новского излучения

IZO /indium-doped  
zinc oxide/  
легированный индием ок-  
сид цинка /ZnO:In/

## J

JD /junction diode/  
планарный диод

JIL /junction iso-  
lation of layer/  
изоляция слоя pn пере-  
ходом

JT /junction transis-  
tor/  
планарный транзистор

JTB /junction ther-  
mal breakdown/  
тепловой пробой перехо-  
да

JTC /junction tran-  
sistor circuit/  
схема на планарных  
транзисторах

## L

LA /layered archi-  
tecture/  
многоуровневая архитек-  
тура /ИС/

LA /longitudinal  
acoustical/  
продольный акустический  
/Фонон/

LA CBED /large-angle  
convergent beam  
electron diffrac-  
tion/  
дифракция сходящегося  
пучка электронов с ши-  
роким углом обзора

LAD /laser-assisted  
disordering/  
деформация /разупорядо-  
чение/, вызванная лазер-  
ным облучением

LAD /laser-assisted  
deposition/  
лазерное нанесение /пле-  
нок/

LAEC /large-area  
electron channeling/  
электронное каналирова-  
ние по большой площади  
/метод исследования  
кристаллических свойств/

LAEDP /large area  
electronic display  
panel/  
большая электронная ин-  
дикаторная панель

LAM /laser-assisted  
machining/  
лазерная обработка

LAPSS /large area  
pulsed solar simu-  
lator/  
импульсный имитатор сол-  
нечного излучения боль-  
шой площади

LASEM /laser + scan-  
ning electron micro-  
scope/

ЛАРЭМ - прибор с лазер-  
ным воздействием на  
объект исследования в  
растровом электронном  
микроскопе /РЭМ/

LASS /laser-activated  
Si switch/  
кремниевый переключатель  
с лазерным управлением

/кремниевый фототи-  
ристор/

LASS /low-angle si-  
licon sheet/  
малоугловая кремниевая  
лента /выращенная с вы-  
сокой скоростью путем  
отверждения на поверх-  
ности расплава/

LB /lead bond/  
проволочный вывод /при-  
соединенный методом  
термокомпрессии/

LBR /laser beam  
reader/  
лазерное считывающее  
устройство

LBW /laser beam  
welding/  
лазерная сварка

LCCD /liquid crystal  
color display/  
цветной жидкокристалли-  
ческий индикатор

LCP /laser-induced  
chemical processing/  
химическое воздействие,  
индуцированное лазерным  
облучением

LCP /liquid crystal  
polymer/  
жидкокристаллический по-  
лимер

LCTV /liquid crystal  
TV/  
телевидение на жидко-  
кристаллических дисплея

LDA /laser diode  
array/  
матрица лазерных диодов

LD <sup>3</sup> /low-doped-double-diffused/ слаболегированная область, полученная методом двойной диффузии	спектроскопия медленных отрицательно заряженных атомов отдачи
LDP /lateral doping gradient/ продольный градиент степени легирования	LFM /laser fusing method/ метод лазерного оплавления
LDPE /low-density polyethylene/ полиэтилен низкой плотности	LFO /laser fuse opening/ лазерный метод пережигания перемычек
LDR /low deposition rate/ медленное осаждение см. также LRD	LFS /laser fuse shorting/ лазерный метод замыкания перемычек оплавлением
LEAM /longitudinal electro-absorption modulator/ оптический модулятор на эффекте продольного электропоглощения	LFSR /linear feedback shift register/ линейный сдвиговый регистр с обратной связью
LEAR /low energy antiprotons reactor/ реактор медленных антипротонов	LGA /leadless grid array/ безвыводный корпус с контактами в узлах сетки
LEF /laser-excited fluorescence/ флуоресценция под действием лазерного излучения	LGS /lanthanum-gallium silicate/ силикат лантана-галлия /La <sub>3</sub> Ga <sub>5</sub> SiO <sub>14</sub> /
LEID /low-energy ion detector/ детектор медленных ионов	LH /liquid hydrogen/ жидкий водород
LEM /laser emission microprobe/ лазерный микрозонд	LHe /liquid helium/ жидкий гелий
LENRS /low-energy negative recoil spectroscopy/	LHPG /laser-heated pedestal growth/ выращивание основания кристалла лазерным нагревом /метод выращивания кристаллов малого диаметра/
	LI /light ion/ легкий ион

LI /local intercon- nection/ локальное межсоединение	LIN /light-induced hole/ оптически индицирован- ная дырка
LIC /line interface circuit/ линейная цепь сопряжения	LIN /low-incident angle nucleation/ нанесение покрытий /за- родышеобразование/ на- пылением при малых уг- лах падения /с после- дующим увеличением угла/
LICVD /laser-induced chemical vapour de- position/ химическое осаждение из паровой фазы с лазерной стимуляцией	LIPD /laser-induced photodesorption/ фотодесорбция под дей- ствием лазерного облу- чения
LID /light-induced donor/ оптически индуцированный донор	LIPP /laser-induced pressure pulse/ метод ударной волны, ин- дуцированной лазерным облучением
LID /lifted diffused layer/ приподнятый диффузионный слой	LIS /laser-induced synthesis/ индуцированный лазерным облучением синтез /по- лупроводниковых соеди- нений/
LIDS /laser-induced disorption spectroscop- y/ спектроскопия лазерно- индуцированной десорбции	LITD /laser-induced thermal desorption/ термодесорбция под дей- ствием лазерного облу- чения
LIE /laser-induced epitaxy/ эпитаксия, индуцирован- ная лазерным облучением	LLS /laser-beam line scanning/ линейное лазерное ска- нирование
LIG /laser-induced grating/ дифракционная решетка, формируемая лазерным излучением	LLST /laser light scattering tomo- graphy/ лазерная томография в рассеянном свете
LIGT /lateral insu- lated gate transistor/ горизонтальный транзис- тор с изолированным затвором	

LMP /large-volume microwave plasma apparatus/  
аппаратура СВЧ-плазменного осаждения

LND /laterally nonuniformly doped structure/  
структура с боковым неоднородным легированием

LNTWA /low-noise travelling-wave amplifier/  
маломощный усилитель на ЛБВ

LO /longitudinal optical/  
продольный оптический /фонон/

LOC /large optical cavity/  
большой оптический резонатор

LO MOST /low-power MOS-transistor/  
маломощный МОП ПТ

LO MOST /long-channel MOS-transistor/  
МОП ПТ с длинным каналом

LOT /laminated overlay transistor/  
слоистый многоэмиттерный транзистор

LOZ /liquid ozone/  
жидкий озон

LP /long persistence/  
длительное последствие

LPD /laser-induced photochemical deposition/  
стимулированное лазерным облучением фотохимическое осаждение

LPEE /liquid phase electroepitaxy/  
жидкофазная электроэпитаксия  
см. также ELDE

LPM /laser precision microfabrication/  
прецизионная микрообработка лазерным лучем

LPO /low pressure oxide/  
оксид низкого давления

LPPW /linearly polarized plane wave/  
линейно поляризованная плоская волна

LPS /liquid phase sintering/  
жидкофазное спекание

LPS /long-period superstructure/  
длинно-периодная сверхструктура

LPW /layered printed wiring/  
слоистый печатный монтаж

LRD /low-rate deposition/  
медленное осаждение  
см. также LDR

LRP /limited reaction processing/  
метод ограниченного /термического/ воздей-

ствия /получение резко-  
го профиля легирования/

LS /lenticular screen/  
линзовый экран

LS /low-power Schott-  
ky/

маломощный диод Шоттки

LSC /liquid scintil-  
lation counter/  
жидкостный сцинтилляцион-  
ный счетчик

LSD /limited space  
charge drift/  
ограниченный дрейф про-  
странственного заряда

LSEM /low-energy  
scanning electron  
microscope/  
растровый электронный  
микроскоп /РЭМ/ на мед-  
ленных электронах

LSFT /low-tempera-  
ture superthin film  
transistor/  
охлаждаемый сверхтонко-  
пленочный транзистор

LSM /laser scanning  
microscope/  
растровый лазерный мик-  
роскоп

LSMS /laser scan  
mass-spectrometry/  
масс-спектрометрия с ла-  
зерным сканированием

LSR /linear shift  
register/  
линейный регистр сдвига

LSW /leaky surface  
wave/  
поверхностная волна  
утечки

LT /laser trimming/  
лазерная подгонка

LTDS /low-tempera-  
ture direct synthesis/  
прямой низкотемператур-  
ный синтез

LTFR /laser-trimmed  
film resistor/  
пленочный резистор с ла-  
зерной подгонкой

LTN LCD /lower-twist-  
ed nematic liquid  
crystal display/  
твист-нематический жид-  
кокристаллический инди-  
катор с небольшим углом  
закручивания

LTO PR /low-tempera-  
ture operation pho-  
toresistor/  
охлаждаемый /жидким азо-  
том/ фоторезистор

LTP /low-temperature  
passivation/  
низкотемпературная пас-  
сивация

LT PL /low-temperatu-  
re photoluminescence/  
низкотемпературная фото-  
люминесценция

LT VTP /linearly-  
with-time varying  
temperature profile/  
метод выращивания/ с  
линейно изменяющимся  
во времени температур-  
ным профилем

LUMOCEN /luminescen-  
ce from molecular  
center/

люминофор, излучающий  
из молекулярных центров  
/напр., ZnS:TbF<sub>3</sub>/

LVBS /low voltage  
backsputtering/  
/травление методом/ низ-  
ковольтного обратного ка-  
тодного распыления

LVE /laser vacuum  
epitaxy/  
лазерная вакуумная эпита-  
кция /ЛВЭ/ /молекулярно-  
лучевая эпитаксия в  
сверхвысоком вакууме с  
лазерным облучением/

LVN /low-voltage  
neon lamp/  
низковольтная неоновая  
/индикаторная/ лампа

LVS /low-velocity  
scanning/  
медленное сканирование

LWL /linewidth loss/  
уход ширины линии

LW PD /long wave-  
length photodiode/  
фотодиод, чувстви-  
тельный в длинноволновой  
области спектра

## М

MAGPIE /magnetically  
stabilized photo-  
initiated impulse-en-  
hanced electrically-  
excited/ discharge  
system

импульсная разрядная  
установка с электричес-  
ким возбуждением и маг-  
нитной стабилизацией

MAI /molecular and  
atomic ion implan-  
tation/

имплантация молекулярных  
и атомарных ионов

MAI /multiple angle  
of incidence ellipso-  
metry/

эллипсометрия при различ-  
ных углах падения излу-  
чения /метод исследова-  
ния морфологии поверх-  
ности/

MALS /macro-cell array  
layout system/  
система топологии базо-  
вого кристалла /логиче-  
ской матрицы/

MAOS /metal-anodic  
oxide-semiconductor/  
МОП-структура с анодным  
оксидом

MAS FET /metal-amor-  
phous Si gate FET/  
ПТ с затвором в виде пе-  
рехода металл / аморфный  
кремний

MATS /microwave ab-  
sorption transient  
spectroscopy/  
релаксационная спектро-  
скопия СВЧ-поглощения

MB CRT /multibeam  
cathode-ray tube/  
многолучевая ЭЛТ

MBIC /monochromatic  
light-beam induced  
current/  
ток, индуцированный мо-  
нохроматическим пучком  
света

MCF /microcleaved  
facet/  
микросколотая грань /кри-  
сталла/

MCRW /metal-clad  
ridge waveguide/  
гребенчатый волновод с  
металлической оболочкой

MCV /multichip vehic-  
le/  
многокристалльная связка

MCZ /magnetic-field  
applied /Czochralski/  
метод Чохральского с  
приложением магнитного  
поля

MD /modulation doping/  
модуляционное легирова-  
ние

MDA /metastable state  
of donor-акцептор  
pairs/  
метастабильное состояние  
донорно-акцепторных пар

MDC /multistage dep-  
ressed collector/  
многокаскадный коллектор  
со сниженным потенциалом  
/для ЛБВ/

MDHJ /modulation-  
doped heterojunction/  
модуляционно-легирован-  
ный гетеропереход

MD-MQW /modulation-  
doped multiple quan-  
tum well structure/  
модуляционно-легирован-  
ная структура с множест-  
вом квантовых ям

MDP /molecular drag  
pump/  
молекулярный насос

MDQW /modulation-  
doped quantum well/  
модуляционно-легирован-  
ная квантовая яма

MDS /metastable deex-  
citation spectroscop-  
y/  
спектроскопия высвечива-  
ния метастабильных уров-  
ней

MEBA /multiscan elect-  
ron beam annealing/  
отжиг многократным ска-  
нированием электронным  
лучем

MED /molecular elect-  
ronic device/  
прибор молекулярной эле-  
ктроники

MEE /migration-enhanc-  
ed epitaxy/  
усиленная миграцией эпи-  
таксия

MEVVA /metal vapour  
vacuum arc/  
вакуумный дуговой разряд  
в парах металла

MFC /mass-flow cont-  
roller/  
регулятор газового по-  
тока

MF<sup>3</sup>R /modified fully-  
framed fully-recessed/  
isolation  
модифицированная техно-  
логия изоляции полностью  
заглубленным слоем окси-  
да внутри рамки

MFOT /multipurpose fiber optic transceiver/ многоцелевой волоконно- оптический приемо-пере- датчик	MIO /monolithically integrated opto- electronics/ монокристаллические оптикоэлектрон- ные ИС
MG-Si /metallurgical- grade Si/ кремний металлургическо- го качества	MIP /microwave-in- duced plasma/ СВЧ-плазма
MGS /metal-glass-sili- con/ структура металл/стекло/ кремний	MIS /multilayer inter- ference structure/ многослойная интерферен- ционная структура
MIE /magnetron ion etching/ магнетронное ионное трав- ление	MIS /multipole ion source/ многополюсный ионный источник
MIG /magnetron in- jection gun/ магнетронный инжекцион- ный прожектор	MIS-IL /MIS-inversion layer/ МДП-структура с инверси- онным слоем у поверхнос- ти
MIG /modified inter- digitated gap/ модифицированный зазор в виде встречно-штыревой структуры	MIX /maximum substra- te current/ режим смещения с макси- мальным током в подлож- ке
MIL PIN PT /mono- lithically integrable lateral pin-phototran- sistor/ фототранзистор с гори- зонтальной pin-структу- рой для монокристаллической ин- теграции	MKS /multi-aperture Kaufman ion source/ многополюсный ионный источник Кауфмана
MLL /mode-locked laser/ лазер с синхронизиро- ванными модами	MLCB /multilayer circuit board/ многослойная печатная плата
	MLE /molecular layer epitaxy/ эпитаксия молекулярного слоя

MLP /multilayered plate/  
многослойная плата

MLR /multilayer reflector/  
многослойный отражатель

MLW /multilayer wiring/  
многослойная разводка

MMA /methyl methacrylate/  
метил-метакрилат /фоторезист/

MMD /micromechanical device/  
микромеханический датчик /кварцевый кристалл/

MMP /multipolar microwave plasma/  
многополюсный /генератор/ СВЧ-плазмы /для травления поверхностей/

MMQW/L/ /modified multi-quantum-well laser/  
лазер на модифицированной многослойной квантово-размерной структуре

MNM /metal-nitride-metal/  
структура металл /SiN/ металл

MOMOM /metal-oxide-metal-oxide-metal/  
структура металл/оксид/металл/оксид/металл

MOMS /metalorganic magnetron sputtering/  
магнетронное распыление в парах металлоорганических соединений

MOMTD /metal-oxide-metal tunnel diode/  
туннельный диод со структурой металл/оксид/металл

MOSSIT /MOS static induction transistor/  
статический индукционный транзистор с МОП-структурой

MOV /metal oxide varistor/  
варистор на основе оксида металла

MP /melt point/  
точка плавления

MPA /microprobe analysis/  
микросондовый анализ, микросондирование

MPL /magnetophotoluminescence/  
магнитофотолуминесценция

MQB /multi-quantum barrier/  
многослойный квантово-размерный барьер /слой в виде сверхрешетки с переменным периодом, но с одинаковой высотой потенциальных барьеров/

MQW CCD /multiple quantum-well CCD/  
ПЭС с многослойным квантово-размерным каналом

MQW FET /multiple quantum well FET/  
ПТ с многослойным квантово-размерным каналом

MQWS /multiple quantum well structure/  
многослойная квантово-размерная структура /многослойная структура с квантовыми ямами/  
MS /magnetron sputtering/  
магнетронное распыление  
MS /master slice/  
базовый кристалл  
MS /melt spinning/  
метод выращивания с вращением расплава  
MS /metal-semiconductor/  
структура металл/полупроводник  
MS /microstrip plate/  
микрополосковый анод  
MS /Mössbauer spectroscopy/  
Мессбауэровская спектроскопия  
MS /mushroom stripe structure/  
грибовидная полосковая структура  
MSC /molecular solar cell/  
молекулярный солнечный элемент /с пленкой органического соединения/  
MSD /magnetoelectric semiconductor device/  
магнитоэлектрический полупроводниковый прибор  
MSE /minimum size effect/

эффект минимального размера /в полупроводниковых структурах/

MSF /multistage flash/

многоступенчатое распыление

MSG /multibeam screen grid/

экранная маска многолучевой ЭЛТ /цветного кинескопа/

MSI /metal/semiconductor interface/

граница раздела металл/полупроводник

MSP /mini-square package/

корпусирование с минимальной площадью

MSSN /mean square signal-to-noise/

среднее квадратичное значение отношения сигнала к шуму

MTEM /microcleavage transmission electron microscope/

просвечивающий электронный микроскоп с поэтапным микроскальванием объекта

MTIS /metal-tunnel-thin insulator-semiconductor/

МДП-структура с туннельно-тонким слоем диэлектрика /барьер Шоттки с увеличенной высотой/

MUBIS /multiple-beam  
interval scanner/  
многолучевое сканирующее устройство с различными лучами

MUPS /multichannel  
pseudo-spark switch/  
многоканальный переключатель на основе псевдоискрового разряда

MVS /many-valley  
semiconductor/  
многодолинный полупроводник

MW /mid-wavelength/  
средняя ИК-область спектра /3-5 мкм/  
см. также MWIR

MWA /microwave  
annealing/  
СВЧ-отжиг /отжиг в СВЧ-печи/

MWIR /mid-wave IR/  
средний ИК-диапазон /3-5 мкм/

MWPR /multiwafer plasma  
reactor/  
плазменный реактор для одновременной обработки многих пластин

MX /matrix/  
матрица

MZT /mercury-zinc  
telluride/  
теллурид цинка-ртути /HgZnTe/

## N

NAIR /narrow absorption IR/

узкая полоса поглощения в ИК-диапазоне

NAM /nonabsorbing  
mirror/  
непоглощающее зеркало

NBH /neutron bombarded  
homogenously  
doped/  
однородно трансмутационно легированный

NBF /narrow band  
filter/  
узкополосный фильтр

NBGS /narrow band-  
gap semiconductor/  
узкозонный полупроводник

NBS /neutral beam  
spectroscopy/  
спектроскопия пучка нейтральных частиц

NCAP /nematic curvilinear  
aligned  
phase/  
нематик с криволинейно выстроенной фазой

NDS /neutron-doped  
Si/  
трансмутационно-легированный кремний

NEG /nonevaporable  
getter/  
нераспыляемый геттер

NEM /negative effective  
mass/  
отрицательная эффективная масса

NENDEP /n-channel  
enhancement/depletion  
IC/

в МОП ИС в режиме обогащения/обеднения

NERFET /negative resistance FET/

ПТ с отрицательным сопротивлением

NEV /noise equivalent vibration/

вибрация, эквивалентная шуму

NIC /near intrinsic crystal/

кристалл с проводимостью, близкой к собственной

NICISS /noble-gas impact collision ion scattering spectroscopy/

спектроскопия ударного рассеяния ионов благородных газов

NIT /neon indicator tube/

неоновая индикаторная лампа

NLCSE /nonlinear charge storage element/

нелинейный элемент с накоплением заряда

NLD /nonlinear distortion/

нелинейное искажение

NMMW /near millimeter wave/

ближний миллиметровый диапазон волн

NO /nitrided oxide/ оксид с нитрированной поверхностью

NOD /noise diode/ шумовой диод

NRA /nuclear reaction analysis/ анализ методом ядерных реакций

NRB /nuclear resonance broadening/ методика ЯМР /ядерного магнитного резонанса/, основанная на измерении уширения резонансной линии

NSD /noise spectral density/ спектральная плотность шума

## О

OA /optical attenuator/ оптический ослабитель

OBD /optical bistable device/ оптически бистабильное устройство

OBD /optical beam deflection/ отклонение светового луча /метод исследования оптоэлектронных свойств материалов/

OCM /orthogonal chip mount/ ортогональный монтаж элементов

OCS /optoelectronic crossbar switch/ оптоэлектронный переключатель

OCTF /optically coupled transversal filter/  
поперечный /ПЭС/-фильтр с оптической связью

OCVD /organic chemical vapour deposition/  
химическое осаждение из паров органических соединений

ODD /optical disk driver/  
система привода оптических дисков

OEG /optical energy gap/  
оптическая ширина энергетической зоны /запрещенной зоны/

OEID /optoelectronic integrated device/  
оптоэлектронный интегральный прибор

OES /optoelectronic switch/  
оптоэлектронный затвор /ключ/

OETBS /optoelectronic triangular barrier switch/  
оптоэлектронный ключ с треугольным барьером

OFCD /overflow control gate/  
антиблуминговый управляющий затвор /в ПЭС: регистре преобразователя изображения/

OFD /overflow drain/  
антиблуминговый сток /в ПЭС-регистре преобразователя изображения/

OFS /optical fiber sensor/  
волоконно-оптический датчик

OGFET /open-gate FET/  
ПТ с открытым затвором /чувствительный к адсорбции газов/  
см. также ADFET

OGS /optogalvanic spectroscopy/  
оптогальваническая спектроскопия

OI /organic-inorganic barrier diode/  
диод с барьером на границе органический/неорганический полупроводник

OMBE /organic MBE/  
МЛЭ из органических соединений

OMI LCD /optical mode interference liquid crystal display/  
жидкокристаллический индикатор с интерференцией оптических мод

OPC /organic photoconductor/  
органический фотопроводящий материал /для электрофотографии/

OPD /optical penetration depth/  
глубина проникновения оптического излучения

OPL /optically pumped laser/  
лазер с оптическим возбуждением /накачкой/

OSEE /opto-stimulated  
exoelectron emission/  
фотостимулированная экзо-  
электронная эмиссия

OSELO /offset local  
oxidation/  
контрастное локальное  
окисление

OSJ /one-sided junc-  
tion/  
односторонний переход

OTD /oxygen thermal  
donor/  
кислородный термодонор

OTDR /optical time  
domain reflectometer/  
оптический рефлектометр  
/счетчик фотонов/

OTS /opposed target  
sputtering/  
метод осаждения распыле-  
нием противоположной ми-  
шени

OVPO /outside vapour-  
phase oxidation/  
наружное окисление из  
паровой фазы

OXER /oxide etch rate/  
скорость травления слоя  
оксида

OXSEF /oxygen-doped  
silicon epitaxial  
film/  
эпитаксиальная пленка  
кремния, легированного  
кислородом

## Р

PAAP /package and  
assembly process/  
сборка и корпусирование

PAC /perturbed angu-  
lar correlation/  
метод возмущений уг-  
ловой корреляции

PACVD /plasma-ac-  
tivated chemical  
vapour deposition/  
плазмохимическое осаж-  
дение из паровой фазы

PAM /polarization  
azimuth modulator/  
оптический модулятор с  
азимутальной поляриза-  
цией

PA MO CVD /photoas-  
sisted metalloorganic  
chemical vapour de-  
position/  
химическое осаждение из  
паров металлоорганичес-  
ких соединений с одно-  
временным освещением  
подложки

PAN /p and n-type  
imager/  
преобразователь изобра-  
жения, состоящий из  
двух отдельных р- и  
n-структур

PAPA /precision ana-  
log photon address/  
прецизионный аналоговый  
счетчик фотонов /на фо-  
тоэлектронном умножителе/

PARA /parasitic re-  
sistance analysis/  
анализ на основе модели  
паразитных сопротивле-  
ний

PAT /photoacoustic-  
thermal effect/  
термофотоакустический  
эффект

PBD /p-plane barrier diode/  
диод с барьером в p-плоскости /n p n/

PBGO /PbBaGeO/  
пироэлектрическая керамика состава  
/Pb<sub>4,95</sub>Ba<sub>0,05</sub>Ge<sub>3</sub>O<sub>11</sub>/

PBMS /photon burst mass-spectroscopy/  
фотовспышечная масс-спектроскопия

PCC /peripheral capacitor cell/  
периферический конденсатор

PCGD /positive column glow discharge/  
положительный столб тлеющего разряда

PC-HCIS /plasma compression type of hollow cathode ion source/  
ионный источник с полым катодом со сжатием плазмы

PCSC /point contact solar cell/  
солнечный элемент с точечным контактом

PCSS /photoconductive semiconductor switch/  
полупроводниковый переключатель на основе фотопроводимости

Pcs /phtalocyanines/  
фталоцианины

PCVD /photo-chemical vapour deposition/

фотохимическое осаждение из паровой фазы

PD /planar doping/  
планарное легирование

PDS /photothermal deflection spectroscopy/  
спектроскопия фототермического отклонения /метод определения плотности дефектов/

PEBA /pulsed electron beam annealing/  
импульсный электронно-лучевой отжиг

PEC /piezoelectric ceramics/  
пьезокерамика

PECVD /plasma-enhanced chemical vapour deposition/  
плазмохимическое осаждение из паровой фазы

PED /potential enhanced doping/  
легирование, усиленное электрическим полем

PEE /photoelectrochemical etching/  
фотоэлектрохимическое травление

PEEO /piezo-electric elasto-optic effect/  
пьезоэлектрический эласто-оптический эффект

PELA /pulsed eximer-laser annealing/  
импульсный отжиг с помощью эксимерного лазера

PESA /proton elastic scattering analysis/  
анализ методом упругого рассеяния протонов

PETS /proximity electron tunneling spectroscopy/  
туннельная электронная спектроскопия в условиях эффекта близости

PFE /photofield effect/  
фотополевой эффект

PFE /photofield emission/  
автофотоэмиссия

PGA /pin grid array/  
штырьково-сеточная матрица

PGI /Penning-discharge gas imager/  
индикаторные панели на основе пеннинговского разряда

PGMA /polyglycin methacrylat/  
полиглицинметакрилат /резист/

PGO /PbGeO/  
пирозлектрическая керамика состава  $Pb_5Ge_3O_{11}$

PHB /photochemical hole burning/  
фотохимическое выжигание отверстий

PHCAP /photocapacitance/  
фотоемкость, фотоемкостная спектроскопия

PHCYD /photochemical CVD/

фотохимическое осаждение из паровой фазы

PHM /perfect hillockless metallization/  
совершенная металлизация /без бугорков/

Photo MO MBE /photo-metalorganic molecular-beam epitaxy/  
комбинация молекулярно-лучевой эпитаксии и фотохимического осаждения из паров металло-органических соединений

PHOTOX /photo-oxidation/  
формирование слоя оксида методом фотохимического осаждения из паровой фазы

PI /polyimide/  
полиимид

PIAS /photon-counting image acquisition system/  
система обработки изображения методом счета фотонов

PIC /photonic IC/  
фотонная ИС

PIG /Penning ionization gauge/  
ионизационный манометр Пеннинга

P-i/MQW/-n /p-i (multiple quantum well/-n)

pin структура с периодической системой квантовых ям в качестве i-слоя

PI/SO /parallel input/serial output/  
параллельный вход/последовательный выход

PITS /photoinduced transient spectroscopy/  
спектроскопия фотоиндуцированных переходных процессов

PJE /pulsed jet epitaxy/  
импульсная струйная эпитаксия

PLA /pulsed laser annealing/  
импульсный лазерный отжиг

PLAP /pulsed laser atom probe/  
импульсный лазерный атомный зонд

PLCC /plastic leaded chip carrier/  
пластиковый кристаллодержатель с выводами

PLD /pulsed laser diode/  
импульсный лазерный диод

PLE /photoluminescence excitation spectroscopy/  
спектроскопия возбуждения фотолюминесценции

PLE /pulsed laser evaporation/  
импульсное лазерное испарение

PLEG /preferential lateral extended guard ring/

охранное кольцо /в ЛФД/, преимущественно вытянутое в горизонтальной плоскости

PLIP /preamplifier-limited performance/  
параметры, ограниченные предусилителем

PLOX /plasma stream oxidation/  
оксидирование плазменной струей

PM /photomodulation spectroscopy/  
фотомодуляционная спектроскопия

PMIPK /polymethylisopropenyl ketone/  
полиметилизопропенил кетон /электрорезист с сухим проявлением/

PMS /photoconductive microwave switch/  
фотопроводящий СВЧ-переключатель

POA /post-oxidation annealing/  
послеокислительный отжиг

POF /plastic optical fiber/  
пластмассовое оптическое волокно

POGS /photoemission optogalvanic spectroscopy/  
фотоэмиссионная оптогальваническая спектроскопия

POLYX /polycrystalline Si/  
поликристаллический Si,  
поликремний

POSOX /polisilicon-on-oxide/  
структура поликремни-  
на оксиде /пленка поли-  
кристаллического кремния  
на слое оксида кремния/

POVD /photoinduced  
open-circuit voltage  
decay/  
спад фотоЭДС /метод из-  
мерения времени жизни  
неосновных носителей/

PPAC /parallele-  
plate avalanche  
chamber/  
камера лавинного пробоя  
с параллельными элект-  
родами

PPG /programmable  
pulse generator/  
программируемый генератор  
импульсов

PPSEM /picosecond  
photoelectron scan-  
ning electron micro-  
scope/  
растровый электронный  
микроскоп /РЭМ/ с Au-  
фотокатодом и пикосе-  
кундным разрешением

PPTD /pulsed photo-  
thermal deformation  
technique/  
метод импульсной фото-  
термической деформа-  
ции

POFP /plastic quad  
flat pack/

пластмассовый плоский  
корпус с четырехряд-  
ными выводами

PQW /patterned quan-  
tum well array/  
фигурная матрица с кван-  
товоразмерным эффектом

PR /photoreflectance/  
оптическое отражение

PRESSFET /pressure  
sensitive FET/  
ПТ чувствительный к из-  
менению давления

PRF /pulse-repeti-  
tion. frequency/  
частота повторения им-  
пульсов

PROFI /processor  
for filtering/  
процессор фильтрации

PSD /power spectral  
density/  
спектральная плотность  
мощности излучения

PSE /photostimulated  
epitaxy/  
фотостимулированная эпи-  
таксия

PSEM /photoelectron  
scanning electron  
microscope/  
растровый электронный  
микроскоп с Au-фотока-  
тодом /вместо термокатада/

PSI /plasma-surface  
interaction/  
взаимодействие плазмы с  
поверхностью /стенки  
камеры/

PSID /photon stimulated ion desorption/  
фотостимулированная десорбция ионов

PSL /planar stripe laser/  
планарный полосковый лазерный диод

PST /PbSnTe/  
свинец-олово-теллур /СОТ/, теллурид свинца-олова

PSTS /photosensitivity transient spectroscopy/  
спектроскопия переходных процессов фоточувствительности

PTC /plumbum titanate ceramics/  
сегнетоэлектрическая керамика на основе титаната свинца /BaPbTiO<sub>3</sub>/

PTCR /plumbum titanate ceramics resistivity effect/  
эффект резкого повышения сопротивления сегнетокерамики на основе титаната свинца /при определенной температуре/

PTD /photonuclear transmutation doping/  
фотоядерное трансмутационное легирование

PTI /photothermal ionization/  
фототермическая ионизация

PTS /partially thickened Si-on-insulator/

структура кремний-на-диэлектрике /КНД/ с частичными утолщениями

PT TL /photo-transferred thermoluminescence/  
термолюминесценция с фотопереносом носителей /с УФ-облучением/

PVC /polyvinyl chloride/  
поливинилхлорид

PVK /polyvinylkarbazole/  
поливинилкарбазол

PW /Pierce gun wiggler/  
модулятор сильноточной электронной пушки /пушки Пирса/

PWA /printed wiring assembly/  
система печатного монтажа

PYS /photoelectric yield spectroscopy/  
спектроскопия фоточувствительности

## Q

QCSE /quantum confined stark effect/  
квантово-ограниченный эффект Штарка

QFP /quad flat pack/  
плоский корпус с четырьмя выводами

QHE /quantized Hall effect/  
квантующийся эффект Холла

QNJ /quadruple heterojunction/  
структура с четырьмя гетеропереходами

QHS /quantum heterostructure/  
гетероструктура с размерным квантованием

QMF /quadrupole mass-filter/  
квадрупольный масс-фильтр

QPF /quadra potential focus/  
квадрупольная фокусирующая система

QTED /quad-tail energy distribution/  
энергетическое распределение с параболическим хвостом

QUD /quantum-well-doped/ FET  
ПТ с легированной квантовой ямой /с двумерным электронным газом/

QWB /quantum well box/  
кванторазмерный ящик

QWCCD /quantum well-channel CCD/  
ПЗС с кванторазмерным каналом

QWEST /quantum well envelope state transitions/  
переходы в верхнее состояние квантовой ямы

QWET /quantum-well emission transistor/  
транзистор с термоэмиссией электронов из квантовой ямы /затвор управляет положением уровня Ферми в квантовой яме/

QWITT /quantum-well injection transit-time diode/  
лавинопролетный диод с квантоворазмерной структурой в инжекционно-пролетном режиме

QWL /quantum well laser/  
лазер на квантово-размерной структуре

QWW /quantum-well wire/  
одномерная структура с квантоворазмерным эффектом

## R

RAD /ribbon against drop/  
нанесение слоя поликристаллического кремния из расплавленной капли на гибкую графитовую ленту

RAFT /ramp-assisted foil casting technique/  
получение фольги техникой литья с наклоном

RBC /radical-beam cleaning/  
очистка /поверхности/ пучком радикалов

RBD /radical-beam  
deposition/  
осаждение из пучка ради-  
калов

RB SOA /reverse-bias  
safe operating area/  
область надежной работы  
/транзистора/ в режиме  
обратного смещения

RCT /reverse conduc-  
tivity thyristor/  
тиристор в режиме обрат-  
ной проводимости

RDL /ring dye laser/  
кольцевой лазер на кра-  
сителях

REFET /reference FET/  
ПТ сравнения /в мостовых  
схемах/

RFP CVD /radio-fre-  
quency plasma chemi-  
cal vapour deposition/  
высокочастотное плазмо-  
химическое осаждение из  
паровой фазы

RFQ /radio-frequency  
quadrupole/  
высокочастотная квадра-  
польная система /фоку-  
сировки/

RNET /resonant-tun-  
neling hot electron  
transistor/  
транзистор на горячих  
электронах с резонанс-  
ным туннелированием

RIBD /reactive ion-  
beam deposition/  
осаждение из пучка реак-  
тивных ионов

RibLOC /rib-wave-  
guide large optical  
cavity/

большой оптический резо-  
натор с реберным вол-  
новодом

RIBS /Rutherford ion  
backscattering spect-  
roscopy/

спектроскопия обратного  
резерфордовского рассея-  
ния

RIBS /reactive ion-  
beam sputtering/  
реактивное ионно-луче-  
вое распыление /метод  
получения аморфных плен-  
ок/

RIBSD /reactive ion-  
beam sputter depo-  
sition/  
осаждение пленок мето-  
дом реактивного ионно-  
лучевого распыления

RID /radical and  
ion assisted depo-  
sition/  
химическое осаждение из  
паровой фазы со стиму-  
ляцией ионами и ради-  
калами

RJ-LCVD /radical jet  
type laser-induced  
chemical vapour de-  
position/  
химическое осаждение из  
паровой фазы с лазерной  
стимуляцией в струе ра-  
дикалов

RO /ridge overgrown/  
заращенная гребенчатая  
структура

ROA /rapid optical annealing/  
быстрый оптический отжиг

RP /resolving power/  
разрешающая способность

RPC /reduced pressure collapsing/  
метод сплющивания при пониженном давлении /изготовление одномодового оптического волокна/

RPECVD /remote plasma-enhanced chemical vapour deposition/  
химическое осаждение из паровой фазы со слабым плазменным усилением

RSPHC /Rutherford scattering pin hole camera/  
камера /спектроскопии/ резерфордовского рассеяния с узкой диафрагмой

RTB /resonant tunneling barrier/  
барьер с резонансным туннелированием

RTO /rapid thermal oxidation/  
быстрое термоокисление

RTR /ribbon-to-ribbon/  
осаждение ленты на ленту /метод изготовления крупнозернистых пластин Si/

## S

SABiCMOS /self-aligned bipolar CMOS/

биполярная КМОП структура с самосовмещением

SAE /selective-area epitaxy/  
избирательная /по площади/ эпитаксия

SAED /selected area electron diffraction/  
избирательная /по площади/ электронная дифрактометрия

SAES /scanning Auger electron spectroscopy/  
сканирующая оже-электронная спектроскопия

SAFET /surface accessible FET/  
ПТ, чувствительный к действию окружающей среды на поверхность затвора /модификация OGFET/

SAINT /self-aligned implantation for n<sup>+</sup> layer technology/  
технология формирования n<sup>+</sup> слоя методом ионной имплантации с самосовмещением

SAL /self-activated luminescence/  
самоактивированная люминесценция

SALICIDE /self-aligned silicide/  
самосовмещенное покрытие силицидом

SALOX /self-aligned oxygen-implanted Si-on-insulator/

структура кремний на ди-  
электрике /КНД/, получен-  
ная ионной имплантацией  
кислорода с самосовмеще-  
нием

SAM /separate absorp-  
tion-multiplication/  
раздельные области опти-  
ческого поглощения и ум-  
ножения носителей /в  
фотоприемнике/

SANICIDE /self-aligned  
nitridation of sili-  
cide/  
нитрирование силицида с  
самосовмещением

SAPD /superlattice  
avalanche photodiode/  
лавинный фотодиод со  
сверхрешеткой

SAPT /self-aligned  
polysilicon bipolar  
transistor/  
самосовмещенный биполяр-  
ный поликремниевый тран-  
зистор

SAS /self-aligned  
structure/  
самосовмещенная структу-  
ра

SASE /selected-area  
sputter epitaxy/  
селективная эпитаксия  
распылением через маску

SAXD /small-angle  
X-ray diffraction/  
малоугловая дифракция  
рентгеновского излуче-  
ния

SBA /self-aligned  
bent active-layer/

самосовмещенная изогну-  
тая активная область

SBCCD /shallow buried  
channel CCD/  
ПЗС с мелким скрытым  
каналом

SBD /surface beha-  
vior diagram/  
диаграмма состояния по-  
верхности

SBE /supertwisted  
birefringence ef-  
fect/  
эффект двулучепреломле-  
ния в супертвистирован-  
ном /жидком кристалле/

SBG /Schottky-bar-  
rier gate/  
затвор с барьером Шот-  
тки /Шоттки-затвор/

SBT /superlattice-  
bipolar transistor/  
биполярный транзистор  
со сверхрешеткой

SBW /symmetrically  
branching waveguide/  
симметрично разветвляю-  
щийся волновод

SC /separate confine-  
ment/  
раздельное ограничение  
/РО/ /в лазерных диодах/

SC /stop-cleaving/  
техника микроскальвания  
зеркал /резонаторов ла-  
зерных диодов/

SCB /superionic  
cluster beam/  
пучок суперионизирован-  
ных кластеров

SCC /surrounded capacitor cell/ ячейка окружающего конденсатора	SDE /source-drain extension/ расстояние исток-сток
SCFL /source-coupled FET logic/ связанная по истоку ПТ логическая схема	SD FET /selectively doped FET/ ПТ с селективно-легированным затвором
SCI/SCM /single-carrier initiated/ single-carrier multiplication/ режим умножения носителей, инициированный единичным носителем /в лавинном фотодиоде/	SDH /selectively doped heterostructure/ селективно-легированная гетероструктура
SCL /stop-cleaved laser/ лазерный диод со сколотым зеркальным резонатором	SDH /standard double heterostructure/ стандартная двойная гетероструктура
SCOT /silicide-base contact technology/ технология контактов на основе силицидов	$S\Delta DH$ /selectively $\delta$ -doped heterostructure/ селективно-легированная гетероструктура с двумерным электронным газом
SCR /semiconductor controlled rectifier/ полупроводниковый тиристор	SDMS /spontaneous desorption time-of-flight mass-spectrometry/ времяпролетная масс-спектрометрия спонтанной десорбции
SD /surface discharge/ поверхностный разряд	SD PDP /surface discharge plasma display panel/ плазменная индикаторная панель с поверхностным разрядом
SD /selectively doped/ избирательно легированный	SE /Schottky-emission/ электронная эмиссия Шоттки
S/D /source/drain region/ область исток/сток ПТ	SE /spectroscopic ellipsometry/ спектроскопическая эллипсометрия
SDB /silicon-wafer direct bonding/ прямое термокомпрессионное крепление кристалла Si на Si подложку /пластину/	

SEAM /scanning electron  
acoustic microscopy/  
сканирующая электронно-  
акустическая микроскопия

SEB /scanned electron  
beam/  
сканирующий электронный  
пучок

SECM /scanning elect-  
rochemical microscope/  
сканирующий электрохими-  
ческий микроскоп

SEED /self electroopt-  
ic effect device/  
прибор с собственным элект-  
рооптическим эффектом

SEREPI /selective  
etch-and-refill  
with epitaxy/  
селективное вытравливан-  
ие и эпитаксиальное  
заращивание /канавки/

SES /surface elect-  
ron states/  
поверхностные электрон-  
ные состояния

SFT /super-thin film  
transistor/  
сверхтонкопленочный  
транзистор

SG /solar grade/  
солнечного качества /ма-  
териал, пригодный для  
изготовления солнечных  
элементов/  
см. также SOG

SGHE /secondary-gene-  
rated hot electrons/  
вторично генерированные  
горячие электроны

SHE /substrate hot  
electrons/  
горячие электроны, эми-  
тирующиеся из подложки

SHEP /superstructure  
high-efficiency pho-  
tovoltaic/  
высокочувствительный фо-  
тогальванический элемент  
со сверхструктурой

SHJ /single hetero-  
junction/  
одиночный гетеропереход

SIALON /Si-Al-O-N/  
сиалон

SIBS /semiinsulating  
buried crescent laser/  
лазерный диод со скрытой  
полуизолирующей серповид-  
ной активной областью

SIC /selectively ion-  
implanted collector/  
коллектор, сформирован-  
ный селективной ионной  
имплантацией

SICOS /sidewall-base  
contact isolation  
symmetrical struc-  
ture/  
симметричная структура  
с боковым базовым контак-  
том /СББК/

SIEL /superficial  
image emphasis litho-  
graphy/  
литография с четким по-  
верхностным рисунком

SIER /silicon etch  
rate/  
скорость травления крем-  
ния

SILO /sealed inter-  
face local oxidation/  
локальное оксидирование  
уплотненной границы раз-  
дела /вариант LOCOS-тех-  
нологии/

SIN /superconductor/  
insulator/normal/  
переход сверхпроводник/  
диэлектрик/нормальный про-  
водник

SINFET /Schottky in-  
jection FET/  
ПТ с инжекцией носите-  
лей через барьер Шоттки

SI/PO /serial input/  
parallel output/  
последовательный вход /  
параллельный выход

SIPOS /semiinsulating  
polycrystalline  
silicon/  
полуизолирующий поликрис-  
таллический кремний

SIRET /Siemens ring  
emitter transistor/  
транзистор с кольцевым  
эмиттером фирмы Siemens

SIS /superconductor/  
insulator/supercon-  
ductor/  
переход сверхпроводник/  
диэлектрик/ сверхпро-  
водник

SI/SO /serial input/  
serial output/  
последовательный вход/  
последовательный выход

SJ /Schottky junction/  
переход Шоттки

SLA /semiconductor  
laser amplifier/  
полупроводниковый лазер-  
ный усилитель

SLAM /scanning laser  
acoustic microscope/  
растровый лазерный акус-  
тический микроскоп

SLB /superlattice  
buffer/  
буферная сверхрешетка

SL-MOD FET /superlat-  
tice modulation-doped  
FET/  
ПТ с модуляционно-леги-  
рованной сверхрешеткой

SL-MO VPE /switched  
laser metalorganic  
vapour-phase depo-  
sition/  
парофазная эпитаксия из  
металлоорганики с лазер-  
ной коммутацией

SLPD /superlattice  
photodetector/  
фотоприемник на сверх-  
решетке

SLPE /selective li-  
quid-phase epitaxy/  
селективная жидкофазная  
эпитаксия

SME /stepwise mono-  
layer epitaxy/  
ступенчатая монослойная  
эпитаксия /с образова-  
нием монослойных ступе-  
нек/

SMOKE /surface mag-  
neto-optic Kerr-ef-  
fect/  
поверхностный магнито-  
оптический эффект Керра

SMSC /semimagnetic semiconductor/  
полумагнитный полупроводник /содержащий ионы Mn или Fe/

SMSR /side-mode suppression ratio/  
коэффициент подавления боковых мод

SNDC /S-shaped negative differential conductivity/  
S-образная отрицательная дифференциальная проводимость /с S-образной ВАХ/

SOG /solar-grade/  
см. SG

SOGIR /spin-on-glass image reversal/  
формирование перевернутого рисунка методом центрифугирования

SOM CVD /selective-area organometallic chemical vapour deposition/  
селективное химическое осаждение из паров металлоорганики

SOMET /senso-opto-microelectronic transducer/  
оптомикроэлектронный датчик, чувствительный к возмущениям среды через изменение электропоглощения

SONOS /poly-Si/oxide/nitride/oxide/semiconductor/

структура поликремний/оксид/нитрид/оксид/полупроводник

SOOZ /Si on oxide/zirconia/  
структура Si/SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>:Y

SOZ /Si on zirconia/  
структура Si на ZrO<sub>2</sub>:Y

SPANNA /six-port automatic network analyzer/  
шестивходный автоматический анализатор схем

SPD /selective poly-Si deposition/  
селективное осаждение поликремния /слоя поликристаллического кремния/

SPEAR /solid-phase epitaxy and re-growth/  
твердофазная эпитаксия и разращивание

SPEC /solid-phase epitaxial crystallization/  
твердофазная эпитаксиальная кристаллизация

Spin-SEM /spin-polarized scanning electron microscope/  
растровый электронный микроскоп высокого разрешения с использованием спин-поляризованных электронов

SPLEED /spin-polarized low-energy electron diffraction/

дифракция медленных  
спин-поляризованных  
электронов

SPME /spectroscopic  
phase-modulated el-  
lipsometry/

спектроскопическая эл-  
липсометрия с фазовой  
модуляцией

SPPS /serial/parallel,  
parallel/serial con-  
version/

последовательно-парал-  
лельное, параллельно/  
последовательное пре-  
образование

SPS /sport-period  
superlattice/

короткопериодная сверх-  
решетка

SPS /surface photo-  
voltage spectroscopy/  
спектроскопия поверхност-  
ной фотоэдс

SP UDT /single-phase  
unidirectional trans-  
ducer/

однофазный однонаправлен-  
ный преобразователь /ПАВ/

SPV /surface photo-  
voltage/

поверхностная фотоэдс

SQWH /single quantum  
well heterostructure/  
гетероструктура с оди-  
ночной квантовой ямой

SRH /Shockley-Read-  
Hall/

закон /рекомбинации/ по  
Шокли-Риду-Холлу

SRN /silicon-rich  
nitride/

обогащенный кремнием  
нитрид /Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/

SRO /silicon-rich  
oxide/

обогащенный кремнием  
оксид /SiO<sub>2</sub> с встроенны-  
ми островками Si/

SRPL /spatially re-  
solved photolumines-  
cence/

фотолюминесценция с  
пространственным разре-  
шением

SRPS /spin-resolved  
photoemission spect-  
roscopy/

фотоэмиссионная спектро-  
скопия с разрешением по  
спину

SRV /surface recom-  
bination velocity/  
скорость поверхностной  
рекомбинации

SRXF /synchrotron-  
radiation X-ray  
fluorescence/

метод рентгеновской флу-  
оресценции с синхротрон-  
ным источником

SSA /solid-state  
amorphization/

аморфизация в твердой  
фазе

SSB /Si surface bar-  
rier detector/

кремниевый поверхностно-  
барьерный детектор /дн-  
од Шоттки/

SSC /saddle-saddle yoke with convergence circuit/  
магнитная отклоняющая система типа седло-седло со сведением лучей

SSCR /surface space charge region/  
приповерхностная область пространственного заряда

SSD-CL /solid-state detector-cathodoluminescence/  
твердотельный детектор катодolumинесценции

SSIMOS /shielded substrate injection MOS/  
МОП-ПТ с защитой от инжекции носителей из подложки

SSI /solid-state imager/  
см. SSIS

SSIS /solid-state image sensor/  
твердотельный преобразователь изображения /ТПИ/  
см. также SSI

SS-LPE /steady-state LPE/  
жидкофазная эпитаксия в стационарном режиме

SSM /saddle-saddle yoke with modulator unit/  
магнитная отклоняющая система типа седло-седло с модулятором для коррекции формы раstra

SSMS /spark source mass spectrometry/  
масс-спектрометрия с искровым источником

SSPG /steady-state photocarrier grating/  
метод /измерения диффузионной длины неосновных носителей/ путем создания стационарной решетки фотогенерированных носителей

SST /stacked switching transistor/  
многоярусный переключающий транзистор

SSV /spectroscopy of surface vibrations/  
спектроскопия поверхностных вибраций /адсорбированных атомов и молекул/

STAIR /superlattice tunneling and absorption by intersubband resonance/  
туннелирование через сверхрешетку с поглощением при межподзонном резонансе /принцип действия фотоприемника/

STC /stacked capacitor/  
многоярусный конденсатор

STD /semiconductor on thermoplastic as dielectric/  
полупроводник на термопластике в качестве диэлектрика

SIN /supertwisted  
nematic/  
супертвистированный не-  
матик /жидкий кристалл/

SUBSIT /superconduc-  
tor-base semiconductor  
insulating transistor/  
транзистор со сверхпрово-  
дящей базой и полупровод-  
никовой изоляцией затвора

Su FET /superconduc-  
ting FET/  
ПТ со сверхпроводящей  
базой

S-W /Staebler-  
Wronski effect/  
эффект Стэблер-Вронски  
/фотоиндуцированное по-  
нижение темновой прово-  
димости/

SWAT /sidewall self-  
alignment technology/  
технология бокового само-  
совмещения

SWD /surface-acoustic  
wave device/  
прибор на поверхностных  
акустических волнах  
/ПАВ/

SWE /stress (strain)  
wave emission/  
метод возбуждения волны  
напряжения /деформации/  
в материале

SWI /semi-well iso-  
lation/  
изоляция полукарманом

SWIR /short-wave IR/  
коротковолновое ИК излу-  
чение /1,5-1,7 мкм/

SXRF /synchrotron  
X-ray fractography/  
рентгеновская фракто-  
графия с синхротронным  
источником

## Т

ТА /transvers(al)  
acoustical/  
поперечный акустический  
/фонон/

TAC /thermo-acoustic  
cell/  
термоакустическая ячейка

TAS /thallium arsenic  
selenide/  
селенид таллия-мышьяка  
/TlAsSe/ /акусто-опти-  
ческий материал/

TBA /two-beam acce-  
lerator/  
двухлучевой ускоритель  
/заряженных частиц/

TC /temperature  
Curie/  
температура /точка/  
Кюри

TC /transparent  
conducting/  
прозрачный проводящий  
/слой/

TCA /trichlorethane/  
трихлорэтан

TCE /trichlorethy-  
lene/  
трихлорэтилен

TCL /transmission  
cathodoluminescence/  
катодолуминесценция,  
наблюдаемая на просвет

TCMS /twin-channel-substrate mesa-guide/  
мезаполосковый световод с двойным каналом в подложке

TCS /transient current spectroscopy/  
спектроскопия переходного тока

TCS /transparent conducting semiconductor/  
прозрачный проводящий полупроводник

TCVD /thermal chemical vapour deposition/  
термохимическое осаждение из паровой фазы

TD /transmutation doping/  
трансмутационное легирование

TDAM /transmissive detector and modulator device/  
приемо-передающее и модулирующее устройство

TDDB /time-dependent dielectric breakdown/  
зависящий от времени пробой диэлектрика

TDH /thermally dependent Hall effect/  
временная зависимость эффекта Холла /метод измерения энергии ионизации компенсирующих центров/

TDL /tunable diode laser/  
перестраиваемый лазерный диод

TE /transparent electrode/  
прозрачный электрод

TEA /transverse-excited atmospheric laser/  
газовый лазер с поперечным возбуждением при атмосферном давлении

TEA /triethylamine/  
триметиламин

TEAM /transverse electro-absorption modulator/  
оптический модулятор поперечного поля на эффекте электропоглощения

TEAS /thermal energy atom scattering/  
рассеяние неускоренных атомов /метод исследования морфологии кристаллов/

TEI /triethylindium/  
триэтилиндий

TEM /transverse electric and magnetic fields/  
система поперечных электрического и магнитного полей

TEN<sub>2</sub> /transversal electric discharge N<sub>2</sub> laser/  
азотный лазер с поперечным электрическим разрядом

TEP /thermoelectric power/  
термоэдс

TFB /tetrafluor-  
borate/  
тетрафторборат

TF LED /thin film  
light emitting diode/  
тонкопленочный светодиод

TG /temperature gra-  
dient/  
градиент температуры

TGT /temperature gra-  
dient technique/  
осаждение методом темпе-  
ратурного градиента

ТНЭТА /tunneling hot-  
electron transfer  
amplifier/  
усилитель на основе тун-  
нельного переноса горя-  
чих электронов

3D /three-dimensional/  
трехмерный

TIBA/l/ /triisobutyl  
Al/  
триизобутил Al

TIC /transmissive  
interference cathode/  
интерференционный полу-  
прозрачный фотокатод

TIR /thermal IR/  
тепловое ИК-излучение

TJ-BH /transverse  
junction buried hete-  
rostructure/  
поперечный переход со  
скрытой гетероструктурой

TJJ /tunnel Josephson  
junction/  
туннельный джозефсоновский  
переход /ТДП/

TLР /two layer pla-  
narization/  
двуслойная планаризация

TMA/l/ /trimethyl  
aluminium/  
триметилалюминий /ме-  
таллоорганическое сое-  
динение/

TMAE /tetradimethyl-  
amine ethylene/  
тетрадиметиламин-этилен  
/газ, используемый для  
наполнения счетчиков  
фотонов с фотокатодом/

TMAE /tetrakis /di-  
methylamine/ ethy-  
lene  
тетракиسدиметиламин  
этилен

TMG/a/ /trimethyl-  
gallium/  
триметилгаллий /металло-  
органическое соедине-  
ние/

TMI/n/ /trimethyl-  
indium/  
триметилиндий /металло-  
органическое соединение/

TMN /trimethylamine/  
триметиламин /N/CH<sub>3</sub>/<sub>3</sub>/

TN LC /twisted nema-  
tic liquid crystal/  
твист-нематический жид-  
кий кристалл

TO /transvers/al/  
optical/  
поперечный оптический  
/фонон/

TOFI MS /time-of-flight isochronous mass-spectrometer/ времяпролетный изохронный масс-спектрометр	TRMC /time-resolved microwave conductivity/ /бесконтактный/ метод измерения проводимости растущих пленок с помощью ВЧ-техники с высоким временным разрешением
TPA /two-photon absorption/ двухфотонное поглощение	TS /tail states/ энергетические состояния в хвостах зон
TPFG /textured poly floating gate/ текстурированный поликремниевый плавающий затвор /для улучшения стирания информации/	TSDC /thermally stimulated depolarization current/ термостимулированный ток деполяризации
TPL /thermophotoluminescence/ термофотолуминесценция	TSE /two shaping elements/ метод выращивания пластин с двумя формообразующими элементами
TPUDT /tri-phase unidirectional transducer SAW/ трехфазный однонаправленный преобразователь ПАВ	TSL /tilted superlattice/ наклонная сверхрешетка
TQ /temperature quenching/ температурное гашение	TSL /twin-stripe laser/ лазерный диод со сдвоенной полосковой структурой
T/R /transmission/reflection modul/ модуль переключения режимов пропускания/отражения /в волоконно-оптических линиях/	TSP /temperature-sensitive parameter/ температурно-зависимый параметр
TRIM /transport of ions in matter/ /механизм/ переноса ионов в материале	TSSG /top-seeded solution growth/ выращивание из раствора с верхней заправкой, /напр., /LaBa <sub>2</sub> CuO <sub>4</sub> /
3-D /triple diffusion/ трехкратный процесс диффузии	TSZ /travelling solvent zone technique/

выращивание монокристаллов методом движущейся зоны растворения

TT CMOS /twin-tub CMOS/ technology

КМОП технология с двумя карманами

TTC /trench transistor cell/

ячейка целевого транзистора

TTEE /thin thermionic emitter of electrons/

тонкопленочный термоэлектронный эмиттер

TTT /T<sup>3</sup>/ /thin tapered-thickness laser/

лазерный диод с активным слоем постепенно уменьшающейся толщины

TVT /thermovacuum treatment/

термовакuumная обработка

TWASE /travelling wave amplified spontaneous emission/

спонтанное излучение, усиленное бегущей волной

TWLA /travelling-wave laser amplifier/

лазерный усилитель бегущей волны

2D /two-dimensional/ двумерный

## U

UDCW /unidirectional distributely-coupled waves/

однонаправленно-связанные волны

UGA /universal gate array/

универсальная матрица логических элементов

UHMW PE /ultrahigh molecular weight polyethylene/

полиэтилен со сверхвысоким молекулярным весом

UMG-Si /upgraded metallurgical-grade Si/

поликристаллический Si повышенного металлургического класса

UR /unstable resonator/

нестабильный резонатор

URSL /unstable resonator semiconductor laser/

полупроводниковый лазер с нестабильным резонатором

UV CVD /ultraviolet chemical vapour deposition/

химическое осаждение из паровой фазы с УФ-облучением

## V

VAB /vertical anti-blooming/

вертикальная система антиблуминга

VAD /vapour-phase axial deposition/  
метод внешнего аксиального осаждения из газовой фазы /технология оптического волокна/

VCC /voltage-current characteristic/  
вольт-амперная характеристика /ВАХ/

VCCD /virtual-phase CCD/  
ПЗС с виртуальной фазой

VCE /vacuum chemical epitaxy/  
вакуумная химическая эпитаксия

VCSEL /vertical cavity surface-emitting laser/  
поверхностно-излучающий лазерный диод с вертикальным резонатором

VDS /vacuum deposition system/  
установка вакуумного осаждения

VE /vacuum emission/  
эмиссия /горячих электронов/ в вакуум /при комнатной температуре/

VE /vacuum evaporation/  
вакуумное напыление

VFD /vacuum fluorescent display/  
вакуумный люминесцентный индикатор

VGF /vertical gradient freeze/

закалка с вертикальным градиентом температуры

VLD /variation of lateral doping/  
структуры, полученные постепенным изменением степени легирования в продольном направлении

VLE /vapour levitation epitaxy/  
левитационная парофазная эпитаксия

VMT /velocity-modulation transistor/  
транзистор с модуляцией скорости носителей заряда

VOD /vertical overflow drain/  
вертикальный сток антиблуминга

VPS /vapour phase soldering/  
парофазная пайка

VR /vertical reactor/  
вертикальный /химический/ реактор

VR /vane resonator/  
резонатор с лопатками /в приборах СВЧ/

VS /vibration spectroscopy/  
вибрационная спектроскопия

VSC /variable size cell/  
ячейка изменяющегося размера

VSSEF /variably spaced superlattice energy filter/

фильтр в виде сверхре-  
шетки с переменным перио-  
дом

VTFT /very thin  
film transistor/

сверхтонкопленочный  
транзистор

$V^2$ TFT /very simple  
very thin TFT/

очень простой сверхтонко-  
пленочный транзистор

VXR /vacuum soft  
X-ray/

вакуумное мягкое рент-  
геновское излучение  
/поглощаемое атмосфе-  
рой/

## W

WB /wire bonding/  
проволочная термокомпрес-  
сионная сварка

WBGs /wide-band-gap  
semiconductor/  
широкозонный полупровод-  
ник

WDS /wavelength  
dispersion system/  
система дисперсии длин  
волн

WIP /wire ion plasma  
E-gun/  
электронная пушка с плаз-  
менным источником с про-  
волочным анодом

WKB /Wentzel-Kramers-  
Brillouin approxima-  
tion/

ВКБ-аппроксимация /вол-  
новой функции в уравне-  
нии Шредингера/

WLR /white light  
response/  
интегральная чувстви-  
тельность /к неразложен-  
ному свету/

WMS /wavelength-mo-  
dulation spectro-  
scopy/  
оптическая модуляционная  
спектроскопия

WS /wave soldering/  
пайка волной припоя

## X

XCC /X-ray induced  
crystal currents/  
индуцированные рентге-  
новским излучением токи  
в кристалле

XCCl /cross-coupled  
cavity laser/  
лазер с перекрестно-  
связанным резонатором

XCR /explosive crys-  
tallization/  
взрывная кристаллизация

XESD /X-ray-induced  
electron stimulated  
desorption/  
индуцированная рентге-  
новским излучением эле-  
ктроностимулированная  
десорбция

XISEE /X-ray induced  
secondary electron  
emission/

индуцированная рентгеновским излучением вторичная электронная эмиссия

XM /X-ray microscope/  
рентгеновский микроскоп

XMA /X-ray microprobe analysis/  
рентгеновский микрозондовый анализ

XRCD /X-ray crystal density/  
рентгеновская плотность кристалла

XRD /X-ray diode/  
рентгеновский диод /рентгеновская трубка/

XRTI /X-ray real time imager/  
прибор для получения рентгеновского изображения в реальном масштабе времени

XSWIS /X-ray standing-wave interference spectroscopy/

спектроскопия интерференции стоячих волн рентгеновского излучения

## Y

Y-junction  
разветвленное соединение

## Z

ZACV /zone axis critical voltage/  
критический потенциал для зонно-осевых картин в электронном микроскопе

ZAMAC /сплав Zn, Al, Mg, Cu/  
сплав с температурой плавления 300°C

ZM /zone melting/  
зонная плавка

Z-MOS /Z-shaped MOS-structure/  
МОП-структура с Z-образной геометрией

ZMR /zone-melt recrystallization/  
рекристаллизация зонной плавкой

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

БИС	большая интегральная схема	/LSI/
ДМОП	двухдиффузионная МОП-структура	/DMOS/
ЗУ	запоминающее устройство	/memory, storage/
ИК	инфракрасный	/IR/
ИС	интегральная схема	/IC/
КМОП	комплементарная МОП-структура	/CMOS/
ЛБВ	лампа бегущей волны	/TWT/
МДП	металл/диэлектрик/ полупроводник	/MIS/
МОП	металл/оксид/полупроводник	/MOS/
МПМ	металл/полупроводник/металл	/MSM/
ПАВ	поверхностная акустическая волна	/SAW/
ПЗС	прибор с зарядовой связью	/CCD/
ПТ	полевой транзистор	/FET/
СБИС	сверхбольшая интегральная схема	/VLSI/
СВЧ	сверхвысокая частота	/MW/
ТТЛ	транзисторно-транзисторная логика	/TTL/
УФ	ультрафиолетовый	/UV/
ЭВМ	электронная вычислительная машина	/Computer/
ЭЛТ	электронно-лучевая трубка	/CRT/

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От составителя .....	3
Английские сокращения и русские эквиваленты .....	4
Условные сокращения .....	69



## ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ ГКНТ

### И АН СССР — КРУПНЕЙШАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СССР ВЫПОЛНЯЕТ ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

научно-технической литературы и документации по естественным, точным техническим и прикладным наукам более чем с 30-ти иностранных языков на русский и с русского языка на иностранные.

### ПРЕДЛАГАЕТ НА ПРОДАЖУ

- Системы машинного перевода /СМП/ для ЕС ЭВМ /для ПЭВМ с 1990 г./
- Автоматизированное рабочее место переводчика /АРМ/ на базе ПЭВМ ЕС 1832 /совместно с НРБ/;
- Реферативные базы данных на МЛ по выполненным переводам.

### БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

- СМП с английского языка на русский — 60 тыс.руб.;
- СМП с немецкого языка на русский — 40 тыс.руб; /с 1990 г./
- Реферативные базы данных на МЛ по выполненным переводам — по прейскуранту

### ВЕДЕТ РАЗРАБОТКУ

- Новых поколений СМП и АРМП с улучшенным качеством перевода и с расширенной лексикой;
- Новых СМП и АРМП для других языковых пар и других технических средств;
- Баз лингвистических, лексических и информационных данных.

### ВЕДЕТ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ ФОНД ВЫПОЛНЕННЫХ В СССР

ПЕРЕВОДОВ + ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА.

### ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

### ВЫПОЛНЯЕТ ВАШЕЙ ФИРМЕ УСЛУГИ ПО ШИРОКОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМЕ.

продукции вашей фирмы среди более 10 тыс. предприятий СССР и зарубежных стран-заказчиков и контрагентов ВЦП.

АДРЕС ВЦП: 117218, Москва, В-218, ул. Кржижановского, 14, корп. 1; телекс 207366 БДЖ, международный телекс 411618; телефоны для справок 124-72-65, 124-72-63

**1 p.**